



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2014 г. № 829

МОСКВА

О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы

Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т :**

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 809 "О федеральной целевой программе "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 51, ст. 6361; 2009, № 9, ст. 1130; 2011, № 38, ст. 5383; 2013, № 18, ст. 2266; 2014, № 5, ст. 503).

Председатель Правительства
Российской Федерации



Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 19 августа 2014 г. № 829

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в федеральную целевую программу
"Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники"
на 2008 - 2015 годы

1. В паспорте Программы:

а) в абзаце пятом позиции, касающейся важнейших целевых индикатора и показателей, цифры "62" заменить цифрами "56", цифры "112" заменить цифрами "110", слово "реструктуризация" заменить словом "реконструкция";

б) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы:

в абзаце первом цифры "175600,705" заменить цифрами "172103,3593";

в абзаце втором цифры "104656,296" заменить цифрами "102752,5207", цифры "62686,506" заменить цифрами "61861,2257", цифры "41969,79" заменить цифрами "40891,295";

в абзаце третьем цифры "70944,409" заменить цифрами "69350,8386";

в) в абзаце двенадцатом позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Программы и показателей социально-экономической эффективности, цифры "125754,3" заменить цифрами "126802,6".

2. В абзаце четвертом подраздела, касающегося целевых индикатора и показателей реализации Программы, раздела II:

а) в предложении третьем цифры "96" заменить цифрами "93";

б) предложение пятое изложить в следующей редакции: "Также к 2015 году в 13 организациях Министерства образования и науки Российской Федерации, Федерального космического агентства и Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом",

производящих продукцию в интересах радиоэлектронного комплекса, будут созданы центры проектирования, а в 15 - осуществлены реконструкция и техническое перевооружение."

3. В разделе IV:

а) в абзаце первом цифры "175600,705" заменить цифрами "172103,3593";

б) в абзаце втором цифры "104656,296" заменить цифрами "102752,5207";

в) в абзаце третьем цифры "62686,506" заменить цифрами "61861,2257";

г) в абзаце четвертом цифры "41969,79" заменить цифрами "40891,295";

д) в абзаце пятом цифры "70944,409" заменить цифрами "69350,8386";

е) в абзаце седьмом цифры "32215,149" заменить цифрами "31856,5436".

4. В разделе VI:

а) в абзаце шестом цифры "66746,5" заменить цифрами "68686,2";

б) в абзаце седьмом цифры "125754,3" заменить цифрами "126802,6";

в) в абзаце девятом цифры "1,57" заменить цифрами "1,6".

5. Приложения № 1 - 4 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к федеральной целевой программе "Развитие
электронной компонентной базы и радиоэлектроники"
на 2008 - 2015 годы
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 19 августа 2014 г. № 829)

ИНДИКАТОР И ПОКАЗАТЕЛИ

реализации мероприятий федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы

	Единица измерения	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
--	----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Индикатор

Достигаемый технологический
уровень электроники

мкм

0,18 0,18 0,13 0,13 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

0,045

Показатели

Увеличение объемов продаж
изделий электронной и
радиоэлектронной техники

млрд.
рублей

19 58 70 95 130 170 210 250 300

	Единица измерения	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Количество разработанных базовых технологий в области электронной компонентной базы и радиоэлектроники (нарастающим итогом)	-	3 - 5	16 - 20	80 - 90	125 - 135	179 - 185	210	230	250	260 - 270
Количество объектов реконструкции и технического перевооружения производств для создания базовых центров системного проектирования в организациях Минпромторга России (нарастающим итогом)	-	1	8	10	14	29	29	30	35	43
Количество объектов реконструкции и технического перевооружения производств для создания базовых центров системного проектирования в организациях Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", производящих продукцию в интересах радиоэлектронного комплекса (нарастающим итогом)	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4

	Единица измерения	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Количество объектов реконструкции и технического перевооружения производств для создания базовых центров системного проектирования в организациях Роскосмоса, производящих продукцию в интересах радиоэлектронного комплекса (нарастающим итогом)	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5
Количество объектов реконструкции и технического перевооружения производств для создания базовых центров системного проектирования в организациях Минобрнауки России, производящих продукцию в интересах радиоэлектронного комплекса (нарастающим итогом)	-	-	1	1	2	2	3	4	4	4
Количество объектов реконструкции и технического перевооружения радиоэлектронных производств в организациях Минпромторга России (нарастающим итогом)	-	-	1	5	8	18	22	32	39	95

	Единица измерения	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Количество объектов реконструкции и технического перевооружения радиоэлектронных производств в организациях ФСТЭК России (нарастающим итогом)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Количество объектов реконструкции и технического перевооружения радиоэлектронных производств в организациях Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", производящих продукцию в интересах радиоэлектронного комплекса (нарастающим итогом)	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8
Количество объектов реконструкции и технического перевооружения радиоэлектронных производств в организациях Роскосмоса, производящих продукцию в интересах радиоэлектронного комплекса (нарастающим итогом)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Количество завершенных поисковых технологических научно-исследовательских работ (нарастающим итогом)	-	1	3	9	9 - 10	10 - 12	12 - 14	14 - 16	16 - 18	20 - 22

	Единица измерения	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Количество реализованных мероприятий по созданию электронной компонентной базы, соответствующей мировому уровню (типов, классов новой электронной компонентной базы) (нарастающим итогом)	-	4	11 - 12	16 - 20	22 - 25	36 - 40	41 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60
Количество создаваемых рабочих мест (нарастающим итогом)	-	450	1020 - 1050	1800 - 2200	3000 - 3800	3800 - 4100	4100 - 4400	4400 - 4700	4700 - 5000	5000 - 6000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к федеральной целевой программе
"Развитие электронной компонентной базы
и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 19 августа 2014 г. № 829)

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год

I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Направление 1. Сверхвысокочастотная электроника

1. Разработка технологий производства мощных сверхвысокочастотных транзисторов на основе гетероструктур материалов группы A ₃ B ₅	128,624	66	62,624							создание базовой
	84	44	40							технологии производства мощных сверхвысокочас- тотных транзисторов на основе гетероструктур материалов группы A ₃ B ₅ для бортовой и наземной аппаратуры (2009 год), разработка комплектов документации в стандар- тах единой системы конструкторской, и технологической и

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
2. Разработка базовой технологии производства монолитных сверхвысокочастотных микросхем и объемных приемо-передающих сверхвысокочастотных субмодулей X-диапазона	<u>202</u> 134	<u>30,5</u> 20	<u>39,5</u> 26	<u>53,25</u> 35,5	<u>31,8</u> 21,2	<u>46,95</u> 31,3	производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии		
							создание базовой технологии производства монолитных сверхвысокочастотных микросхем и объемных приемо-передающих сверхвысокочастотных субмодулей X-диапазона на основе гетероструктур материалов группы A ₃ B ₅ для бортовой и наземной аппаратуры радиолокации, средств связи (2013 год), разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии		
3. Разработка базовой технологии производства мощных	<u>212,75</u> 134,75	<u>141,75</u> 87,75	<u>71</u> 47	создание технологии производства мощных транзисторов					

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
сверхвысокочастотных полупроводниковых приборов на основе нитридных гетеро- эпитаксиальных структур									сверхвысокочастотного диапазона на основе нитридных гетероэпитаксиальных структур для техники связи, радиолокации (2009 год)
4. Разработка базовой технологии и библиотеки элементов для проектирования и производства монолитных интегральных схем сверхвысокочастотного диапазона на основе нитридных гетероэпитаксиальных структур	<u>531</u> 375	<u>20</u> 17	<u>77,5</u> 65	<u>163,5</u> 109	<u>118</u> 80	<u>152</u> 104			создание технологий производства на основе нитридных гетероэпитак- сиальных структур мощных сверхвысокочас- тотных монолитных интегральных схем с рабочими частотами до 20 ГГц для техники связи, радиолокации (2013 год), разработка комплектов документа- ции в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
5. Разработка базовой технологии производства сверхвысокочастотных компонентов и сложных функциональных блоков для сверхвысокочастотных интегральных схем высокой степени интеграции на основе гетероструктур "кремний - германий"	<u>149,257</u> 101,7	<u>85,757</u> 59,7	<u>63,5</u> 42						создание базовой технологии производства компонентов для сверхвысокочастотных интегральных схем диапазона 2 - 12 ГГц с высокой степенью интеграции для аппаратуры радиолокации и связи бортового и наземного применения, а также бытовой и автомобильной электроники (2009 год), разработка комплексов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии
6. Разработка базовой технологии производства сверхвысокочастотных интегральных схем высокой степени	<u>248,55</u> 158,1		<u>5,6</u> 5	<u>65,8</u> 35	<u>177,15</u> 118,1				создание базовой технологии производства сверхвысокочастотных интегральных схем диапазона 2 - 12 ГГц с высокой степенью

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год

интеграции на основе
гетероструктур
"кремний - германий"

интеграции для аппарату-
ры радиолокации и связи
бортового и наземного
применения, а также
бытовой и автомобиль-
ной электроники
(2011 год), разработка
комплектов документа-
ции в стандартах единой
системы конструктор-
ской, технологической и
производственной
документации, ввод
в эксплуатацию
производственной линии

7. Разработка
аттестованных
библиотек сложно-
функциональных блоков
для проектирования
сверхвысокочастотных
и радиочастотных
интегральных схем на
основе гетероструктур
"кремний - германий"

448,408
308,75

253
169

195,408
139,75

разработка
аттестованных библиотек
сложнофункциональных
блоков для проектиро-
вания широкого спектра
сверхвысокочастотных
интегральных схем на
SiGe с рабочими
частотами до 150 ГГц,
разработка комплектов
документации в
стандартах единой
системы конструктор-
ской, технологической и

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
8. Разработка базовых технологий проектирования кремний-германиевых сверхвысокочастотных и радиочастотных интегральных схем на основе аттестованной библиотеки сложно-функциональных блоков	<u>217,44</u> 142		<u>47</u> 30	<u>80,09</u> 52	<u>58,95</u> 39,3	<u>17</u> 11,3	<u>14,4</u> 9,4		производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии создание базовых технологий проектирования на основе аттестованной библиотеки сложнофункциональных блоков широкого спектра сверхвысокочастотных интегральных схем на SiGe с рабочими частотами до 150 ГГц (2013 год), разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии создание базовых технологий производства элементной базы для высокоплотных источников вторичного электропитания
9. Разработка базовых технологий производства элементной базы для ряда силовых герметичных модулей	<u>114,9</u> 74	<u>60</u> 40	<u>54,9</u> 34						

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Ожидаемые результаты		
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год		2014 год	2015 год
высокоплотных источников вторичного электропитания вакуумных и твердотельных сверхвысокочастотных приборов и узлов аппаратуры										сверхвысокочастотных приборов и узлов аппаратуры (2009 год), разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструктор- ской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии
10. Разработка базовых технологий производства ряда силовых герметичных модулей высокоплотных источников вторичного электропитания вакуумных и твердотельных сверхвысокочастотных приборов и узлов аппаратуры	<u>126,913</u> 73,1			<u>79,513</u> 41,5	<u>47,4</u> 31,6					создание базовых конструкций и технологии производства высокоэффективных, высокоплотных источников вторичного электропитания сверхвысокочастотных приборов и узлов аппаратуры на основе гибридно-плёночной технологии с примене- нием бескорпусной элементной базы (2011 год), разработка комплектов документа- ции в стандартах единой

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	
11. Разработка базовых конструкций и технологии производства корпусов мощных сверхвысоко-частотных транзисторов X-, C-, S-, L- и P-диапазонов из малотоксичных материалов с высокой теплопроводностью	$\frac{226}{152}$	$\frac{151,2}{102}$	$\frac{74,8}{50}$					системы конструктор-ской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии
								создание технологии массового производства ряда корпусов мощных сверхвысокочастотных приборов для "бесвинтовой" сборки (2009 год), разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструктор-ской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии
12. Разработка базовых конструкций теплоотво- дящих элементов систем охлаждения сверхвысо- кочастотных приборов X- и C-диапазонов на основе новых материалов	$\frac{83,5}{55}$		$\frac{13}{8}$	$\frac{40,5}{27}$	$\frac{30}{20}$			создание базовых конструктивных рядов элементов систем охлаждения аппаратуры X- и C-диапазонов наземных, корабельных и воздушно-космических комплексов

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
13. Разработка базовой технологии производства теплоотводящих элементов систем охлаждения сверхвысокочастотных приборов X- и C-диапазонов на основе новых материалов	$\frac{109}{62}$			$\frac{64}{32}$	$\frac{45}{30}$				создание технологии массового производства конструктивного ряда элементов систем охлаждения аппаратуры X- и C-диапазонов наземных, корабельных и воздушно-космических комплексов (2011 год), разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии
14. Разработка базовых технологий производства суперлинейных кремниевых сверхвысокочастотных транзисторов S- и L-диапазонов	$\frac{13}{8}$		$\frac{13}{8}$						создание технологии массового производства конструктивного ряда сверхвысокочастотных транзисторов S- и L-диапазонов для техники связи, локации и контрольной аппаратуры (2009 год), разработка комплектов документации в стандартах единой

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
15. Разработка конструктивно-параметрического ряда суперлинейных кремниевых сверхвысокочастотных транзисторов S- и L-диапазонов	<u>208,9</u> 115,9			<u>139,9</u> 69,9	<u>69</u> 46				системы конструктор-ской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии создание конструктивно-параметрического ряда сверхвысокочастотных транзисторов S- и L- диапазонов для техники связи, локаций и контрольной аппаратуры, разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструктор-ской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии
16. Разработка технологии измерений и базовых конструкций установок автоматизированного измерения параметров нелинейных моделей	<u>32</u> 22	<u>18</u> 12	<u>14</u> 10						разработка метрологи-ческой аппаратуры нового поколения для исследования и контроля параметров полупро-водниковых структур,

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
сверхвысокочастотных полупроводниковых структур, мощных транзисторов и сверхвысокочастотных монолитных интегральных схем X-, C-, S-, L- и P- диапазонов для их массового производства									активных элементов и сверхвысокочастотных монолитных интегральных схем в производстве и при их использовании
17. Исследование и разработка базовых технологий для создания нового поколения мощных вакуумно-твердотель- ных сверхвысокочастот- ных приборов и гибрид- ных малогабаритных сверхвысокочастотных модулей с улучшен- ными массогабарит- ными характеристиками, магнитоэлектри- ческих приборов сверхвысокочастотного диапазона, в том числе циркуляторов и фазовращателей,	<u>149,416</u> 102	<u>84,916</u> 59	<u>64,5</u> 43						создание технологий унифицированных сверхширокополосных приборов среднего и большого уровня мощности сантиметрового диапазона длин волн и сверхвысокочастотных магнитоэлектрических приборов для перспективных радиоэлектронных систем и аппаратуры связи космического базирования (2009 год), разработка комплектов документации в стандартах единой

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
вентилей, высокочастотных резонаторов, перестраиваемых фильтров, микроволновых приборов со спиновым управлением для перспективных радиоэлектронных систем двойного назначения									системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии
18. Разработка базовых конструкций и технологий производства нового поколения мощных вакуумно-твердотельных сверхвысокочастотных приборов и гибридных малогабаритных сверхвысокочастотных модулей с улучшенными массогабаритными характеристиками, магнитоэлектрических приборов сверхвысокочастотного диапазона, в том числе циркуляторов и фазовращателей,	<u>118,45</u> 85,3	<u>77,5</u> 58		<u>40,95</u> 27,3					разработка конструктивных рядов и базовых технологий производства сверхширокополосных приборов среднего и большого уровня мощности сантиметрового диапазона длин волн и сверхвысокочастотных магнитоэлектрических приборов для перспективных радиоэлектронных систем и аппаратуры связи космического базирования (2011 год), разработка комплектов документации в стандартах единой

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе								Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	

комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии

20. Разработка базовых конструкций и технологий производства нанополеночных малогабаритных сверхвысокочастотных резисторно-индуктивно-емкостных матриц многофункционального назначения для печатного монтажа	<u>84,5</u>	<u>50</u>	<u>34,5</u>	создание конструктивных рядов и базовых технологий производства нанополеночных малогабаритных сверхвысокочастотных резисторно-индуктивно-емкостных матриц многофункционального назначения для печатного монтажа (2011 год), разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии
	53	30	23	

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
21. Разработка базовой технологии сверхвысокочастотных p-i-n диодов, матриц, узлов управления и портативных фазированных блоков аппаратуры миллиметрового диапазона длин волн на основе магнитоэлектронных твердотельных и высокоскоростных цифровых приборов и устройств с функциями адаптации и цифрового диаграммообразования	<u>133,314</u> 88	<u>63,447</u> 42	<u>69,867</u> 46						создание базовой технологии производства элементов и специальных элементов и блоков портативной аппаратуры миллиметрового диапазона длин волн для нового поколения средств связи, радиолокационных станций, радионавигации, измерительной техники, автомобильных радаров, охранных и сигнальных устройств (2009 год), разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии	
22. Разработка базовых технологий создания мощных вакуумных сверхвысокочастотных устройств	<u>2323,262</u> 1528,566	<u>338</u> 230	<u>295,11</u> 193,1	<u>364,823</u> 226,98	<u>380,85</u> 253,9	<u>320</u> 210	<u>189,8</u> 124,8	<u>210,129</u> 140,086	<u>224,55</u> 149,7	создание конструктивных рядов и базовых технологий проектирования и производства мощных и

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе								Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	

сверхмощных вакуумных
сверхвысокочастотных
приборов для аппаратуры
широкого назначения
нового поколения
(2009 год, 2011 год),
включая разработку
конструкций
многолучевых
электронно-оптических
систем, включая
автоэмиссионные катоды
повышенной мощности и
долговечности
(2012 год), мощных
широкополосных ламп
бегущей волны
импульсного и
непрерывного действия,
магнетронов, тетродов
миллиметрового
диапазона (2013 год),
малогабаритных
ускорителей электронов
с энергией до 10 МЭВ
для терапевтических и
технологических приложений
(2014 год)

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе								Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
23. Разработка базовых технологий создания мощных твердотельных сверхвысокочастотных устройств на базе нитрида галлия	<u>1658,481</u> 1094,1	<u>158,001</u> 103	<u>253,012</u> 166,5	<u>296,269</u> 192,4	<u>293,55</u> 195,7	<u>287,35</u> 189,9	<u>122,05</u> 81,1	<u>109,875</u> 73,25	<u>138,374</u> 92,25	создание базовых конструкций и технологий изготовления сверхвысокочастотных мощных приборов на структурах с использованием нитрида галлия (2008 год, 2010 год), включая создание гетеропереходных полевых транзисторов с барьером Шоттки с удельной мощностью до 3 - 4 Вт/мм и рабочими напряжениями до 30 В, исследования и разработку технологий получения гетероструктур на основе слоев нитрида галлия на изоляторе и высокоомных подложках (2013 год), разработку технологий получения интегральных схем, работающих в экстремальных условиях (2015 год)

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
24. Исследование перспективных типов сверхвысокочастотных приборов и структур, разработка технологических принципов их изготовления	1046,46 698,32				160,2 106,8	99,5 67,02	274,5 183	298,88 199,25	213,38 142,25	исследование технологических принципов формирования перспективных сверхвысокочастотных приборов и структур, включая создание наногетероструктур, использование комбинированных (электронных и оптических методов передачи и преобразования сигналов), определение перспективных методов формирования приборных структур, работающих в частотных диапазонах до 200 ГГц
25. Разработка перспективных методов проектирования и моделирования сложной функциональной сверхвысокочастотной электронной компонентной базы	1017,375 680,525				49,2 32,8	331,7 224,7	221,4 147,6	238,375 157,625	176,7 117,8	создание полного состава прикладных программ проектирования и оптимизации сверхвысокочастотной электронной компонентной базы, включая проектирование активных приборов, полосковых линий передачи, согласующих

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	

компонентов,
формируемых в едином
технологическом
процессе

Всего по направлению 1 9694 1485,57 1392,821 1375395 1603,5 1205,35 1021,1 857,259 753,004
6405,611 993,95 929,35 855,78 1069 804,12 681,2 570,211 502

Направление 2. Радиационно стойкая электронная компонентная база

26. Разработка базовой
технологии
радиационно стойких
сверхбольших
интегральных схем
уровня 0,5 мкм на
структурах "кремний на
сапфире" диаметром
150 мм

106,65 60 46,65
79,65 38 41,65

создание технологии
изготовления микросхем
на структурах "кремний
на сапфире" диаметром
150 мм (2009 год),
разработка правил
проектирования базовых
библиотек элементов и
блоков цифровых и
аналоговых сверхболь-
ших интегральных схем
расширенной номен-
клатуры для организации
производства
радиационно стойкой
элементной базы,
обеспечивающей выпуск
специальной аппаратуры
и систем, работающих в
экстремальных условиях
(атомная энергетика,
космос, военная техника)

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
27. Разработка базовой технологии радиационно стойких сверхбольших интегральных схем уровня 0,35 мкм на структурах "кремний на сапфире" диаметром 150 мм	<u>286,65</u> 188,1			<u>39,2</u> 19,6	<u>170,25</u> 113,5	<u>53,2</u> 37,2	<u>24</u> 17,8		создание технологии изготовления микросхем с размерами элементов 0,35 мкм на структурах "кремний на сапфире" диаметром 150 мм (2013 год), разработка правил проектирования базовых библиотек элементов и блоков цифровых и аналоговых сверхбольших интегральных схем, обеспечивающих создание расширенной номенклатуры быстройдействующей и высокоинтегрированной радиационно стойкой элементной базы
28. Разработка базовой технологии проектирования и конструктивно-технологических решений библиотек логических и аналоговых элементов, оперативных запоминающих устройств, постоянных запоминающих	<u>245,904</u> 164	<u>130</u> 87	<u>115,904</u> 77						создание технологического базиса (технология проектирования, базовые технологии), позволяющего разрабатывать радиационно стойкие сверхбольшие интегральные схемы на структурах "кремний на изоляторе" с проектной

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
устройств, сложно-функциональных радиационно стойких блоков контроллеров по технологии "кремний на изоляторе" с проектными нормами до 0,25 мкм									нормой до 0,25 мкм (2009 год)
29. Разработка технологии проектирования и конструктивно-технологических решений библиотеки логических и аналоговых элементов, оперативных запоминающих устройств, постоянных запоминающих устройств, сложно-функциональных радиационно стойких блоков контроллеров по технологии "кремний на изоляторе" с проектными нормами до 0,18 мкм	<u>365,35</u> 235			<u>108,6</u> 54,3	<u>166,05</u> 110,7	<u>67,7</u> 52,6	<u>23</u> 17,4		создание технологического базиса (технология проектирования, базовые технологии), позволяющего разрабатывать радиационно стойкие сверхбольшие интегральные схемы на структурах "кремний на изоляторе" с проектной нормой до 0,18 мкм
30. Разработка базовых технологических процессов изготовления радиационно стойкой	<u>141,75</u> 97,65	<u>92</u> 63	<u>49,75</u> 34,65						создание технологического процесса изготовления сверхбольших интегральных схем

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
элементной базы для сверхбольших интегральных схем энергонеависимой пьезоэлектрической и магниторезистивной памяти с проектными нормами 0,35 мкм и пассивной радиационно стойкой элементной базы									энергонеависимой, радиационно стойкой сегнетоэлектрической памяти уровня 0,35 мкм и базовой технологии создания, изготовления и аттестации радиационно стойкой пассивной электронной компо- нентной базы (2009 год)
31. Разработка базовых технологических процессов изготовления радиационно стойкой элементной базы для сверхбольших интег- ральных схем энергоза- висимой пьезоэлектри- ческой и магниторезис- тивной памяти с проектными нормами 0,18 мкм и пассивной радиационно стойкой элементной базы	<u>257,45</u> 159,2	<u>74,6</u> 37,3		<u>130,35</u> 86,9	<u>42,3</u> 28,2	<u>10,2</u> 6,8			создание технологичес- кого процесса изготовле- ния сверхбольших интегральных схем энергонеависимой, радиационно стойкой сегнетоэлектрической памяти уровня 0,18 мкм (2010 год) и создания, изготовления и аттестации радиационно стойкой пассивной электронной компонен- тной базы (2013 год)
32. Разработка технологий "кремний на сапфире" изготовления ряда	<u>110,736</u> 73	<u>58,609</u> 38	<u>52,127</u> 35						разработка расширенного ряда цифровых процессоров, микро-

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
лицензионно- независимых радиационно стойких комплементарных полевых полупроводни- ковых сверхбольших интегральных схем цифровых процессоров обработки сигналов, микроконтроллеров и схем интерфейса									контроллеров, оператив- ных запоминающих программируемых и перепрограммируемых устройств, аналого- цифровых преобразователей в радиационно стойком исполнении для создания специальной аппаратуры нового поколения
33. Разработка технологии структур с ультратонким слоем кремния на сапфире	<u>370,802</u> 231,7	<u>82,952</u> 39,8	<u>190,35</u> 126,9	<u>72,6</u> 48,4	<u>24,9</u> 16,6				создание технологии проектирования и изготовления микросхем и сложнофункцио- нальных блоков на основе ультратонких слоев на структуре "кремний на сапфире", позволяющей разрабаты- вать радиационно стойкие сверхбольшие интегральные схемы с высоким уровнем радиационной стойкости (2013 год)

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
34. Разработка базовой технологии и приборно-технологического базиса производства радиационно стойких сверхбольших интегральных схем "система на кристалле", радиационно стойкой силовой электроники для аппаратуры питания и управления	<u>92,669</u> 73,15	<u>51</u> 40	<u>41,669</u> 33,15						разработка конструкции и модели интегральных элементов и технологического маршрута изготовления радиационно стойких сверхбольших интегральных схем типа "система на кристалле" с расширенным температурным диапазоном, силовых транзисторов и модулей для бортовых и промышленных систем управления с пробивными напряжениями до 75 В и рабочими токами коммутации до 10 А (2009 год)
35. Разработка элементной базы радиационно стойких интегральных схем на основе полевых эмиссионных микронанотриодов	<u>74,471</u> 50,6	<u>36,2</u> 26,1	<u>38,271</u> 24,5						создание ряда микронанотриодов и микронанодиодов с наивысшей радиационной стойкостью для долговечной аппаратуры космического базирования

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
36. Создание информационной базы радиационно стойкой электронной компонентной базы, содержащей модели интегральных компонентов, функционирующих в условиях радиационных воздействий, создание математических моделей стойкости электронной компонентной базы, создание методик испытаний и аттестации электронной компонентной базы	<u>256,6</u> 167,3			<u>21,4</u> 10,7	<u>25</u> 16,6	<u>92,4</u> 61,6	<u>117,8</u> 78,4		разработка комплекса моделей расчёта радиационной стойкости электронной компонентной базы для определения технически обоснованных норм испытаний	
37. Разработка библиотек стандартных элементов и сложнофункциональ- ных блоков для создания радиационно стойких сверхбольших интегральных схем	<u>847,488</u> 565,025				<u>105</u> 70	<u>184,5</u> 123	<u>251,2</u> 167,5	<u>195,038</u> 130,025	<u>111,75</u> 74,5	создание технологии проектирования и изготовления микросхем и сложнофункцио- нальных блоков на основе ультратонких слоев на структуре "кремний на сапфире", позволяющей разрабатывать

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
38. Разработка расширенного ряда радиационно стойких сверхбольших интегральных схем для специальной аппаратуры связи, обработки и передачи информации, систем управления	<u>921,488</u> 613,825				<u>187,5</u> 125	<u>185</u> 123	<u>141,25</u> 94	<u>216,75</u> 144,5	<u>190,988</u> 127,325	радиационно стойкие сверхбольшие интегральные схемы с высоким уровнем радиационной стойкости (2012 год, 2015 год) разработка расширенного ряда цифровых процессоров, микро- контроллеров, оператив- ных запоминающих программируемых и перепрограммируемых устройств, аналого- цифровых преобразователей в радиационно стойком исполнении для создания специальной аппаратуры нового поколения, разработка конструкции и модели интегральных элементов и технологического маршрута изготовления радиационно стойких сверхбольших интегральных схем типа "система на кристалле" с

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
39. Разработка и совершенствование методов моделирования и проектирования радиационно стойкой элементной базы	<u>834,4801</u>								
	555,9867				<u>75</u> 50	<u>275</u> 183	<u>210,75</u> 140,5	<u>128,1551</u> 85,4367	<u>145,575</u> 97,05
									разработка комплекса моделей расчета радиационной стойкости электронной компонент- ной базы для определе- ния технически обосно- ванных норм испытаний
40. Разработка и совершенствование базовых технологий и конструкций	<u>916,75</u>								
	602				<u>180</u> 120	<u>191</u> 123	<u>177,5</u> 113,5	<u>189,75</u> 126,5	<u>178,5</u> 119
									создание технологического базиса (технология проектирования, базовые

расширенным темпера-
турным диапазоном,
силовых транзисторов и
модулей для бортовых и
промышленных систем
управления с пробив-
ными напряжениями до
75 В и рабочими токами
коммутации до 10 А,
создание ряда микро-
наноустройств и микро-
наноустройств с наивысшей
радиационной
стойкостью для
долговечной аппаратуры
космического
базирования

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
радиационно стойких сверхбольших интегральных схем на структурах "кремний на сапфире" и "кремний на изоляторе" с топологическими нормами не менее 0,18 мкм										технологии), позволя- ющего разрабатывать радиационно стойкие сверхбольшие интегральные схемы на структурах "кремний на сапфире" с проектной нормой не менее 0,18 мкм (2014 год), создание технологичес- кого базиса (технология проектирования, базовые технологии), позволяю- щего разрабатывать радиационно стойкие сверхбольшие интегральные схемы на структурах "кремний на изоляторе" с проектной нормой не менее 0,18 мкм (2015 год)
Всего по направлению 2	<u>5829,2381</u> 3856,1867	<u>427,809</u> 292,1	<u>344,371</u> 245,95	<u>326,752</u> 161,7	<u>1229,5</u> 819,6	<u>1163,7</u> 780	<u>980,6</u> 652,5	<u>729,6931</u> 486,4617	<u>626,813</u> 417,875	
		Направление 3. Микросистемная техника								
41. Разработка базовых технологий микро- электромеханических систем	<u>184,215</u> 117,9	<u>165,053</u> 105,9	<u>19,162</u> 12	создание базовых технологий (2009 год) и комплектов технологической						

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе								Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	

42. Разработка базовых конструкций микроэлектромеханических систем	423,712	87,239	73,473	108	82,5	72,5	документации на изготовление микро-электромеханических систем контроля давления, микро-акселерометров с чувствительностью по 2 и 3 осям, микромеханических датчиков угловых скоростей, микроактюаторов				
	263,8	42,1	49,7	72	55	45					
							разработка базовых конструкций и комплектов необходимой конструкторской документации на изготовление чувствительных элементов и микросистем контроля давления, микроакселерометров, микромеханических датчиков угловых скоростей, микроактюаторов с напряжением управления, предназначенных для использования в				

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год

транспортных средствах, оборудовании топливно-энергетического комплекса, машиностроении, медицинской технике, робототехнике, бытовой технике

43. Разработка базовых технологий микроакустических систем

202,784
132,15

122,356
78,55

44,428
29,6

36
24

создание базовых технологий (2009 год) и комплектов необходимой технологической документации на изготовление микроакустических систем, основанных на использовании поверхностных акустических волн (диапазон частот до 2 ГГц) и объемно-акустических волн (диапазон частот до 8 ГГц), пьезокерамических элементов, совместимых с интегральной технологией микроэлектроники

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
44. Разработка базовых конструкций микро-акустоэлектромеханических систем	$\frac{411,574}{258,8}$		$\frac{52}{28}$	$\frac{103,825}{60,3}$	$\frac{88,5}{59}$		$\frac{167,249}{111,5}$		разработка базовых конструкций и комплектов необходимой конструкторской документации на изготовление пассивных датчиков физических величин микроакселерометров, микрогироскопов на поверхностных акустических волнах, датчиков давления и температуры, датчиков деформации, крутящего момента и микроперемещений, резонаторов
45. Разработка базовых технологий микроаналитических систем	$\frac{37}{25}$	$\frac{37}{25}$							создание базовых технологий изготовления элементов микроаналитических систем, чувствительных к газовым, химическим и биологическим компонентам внешней среды, предназначенных для использования в аппаратуре жилищно-коммунального хозяйства

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	

ва, в медицинской и биомедицинской технике для обнаружения токсичных, горючих и взрывчатых материалов

46. Разработка базовых конструкций микроаналитических систем

134
78

47 60
20 40

27 18

создание базовых конструкций микроаналитических систем, предназначенных для аппаратуры жилищно-коммунального хозяйства, медицинской и биомедицинской техники, разработка датчиков и аналитических систем миниатюрных размеров с высокой чувствительностью к сверхмалым концентрациям химических веществ для осуществления мониторинга окружающей среды, контроля качества пищевых продуктов и контроля утечек опасных и вредных веществ в технологических процессах

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
47. Разработка базовых технологий микро-оптоэлектронных механических систем	<u>42,444</u> 27	<u>15,358</u> 10,2	<u>27,086</u> 16,8						создание базовых технологий выпуска трехмерных оптических и акустооптических функциональных элементов, микрооптоэлектронных механических систем для коммутации и модуляции оптического излучения, акустооптических перестраиваемых фильтров, двухмерных управляемых матриц микрозеркал, микропереключателей и фазовращателей (2009 год)
48. Разработка базовых конструкций микро-оптоэлектронных механических систем	<u>109,278</u> 70		<u>33,95</u> 21	<u>48,328</u> 31	<u>27</u> 18				разработка базовых конструкций и комплектов конструкторской документации на изготовление микрооптоэлектронных механических систем коммутации и модуляции оптического излучения

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
49. Разработка базовых технологий микросистем анализа магнитных полей	<u>55,008</u> 36	<u>55,008</u> 36							создание базовых технологий изготовления микросистем анализа магнитных полей на основе анизотропного и гигантского магниторезистивного эффектов, квазиомонолитных и монолитных гетеромагнитных пленочных структур (2008 год)
50. Разработка базовых конструкций микросистем анализа магнитных полей	<u>153,518</u> 98,018		<u>39,518</u> 22,018	<u>93</u> 62	<u>21</u> 14				разработка базовых конструкций и комплектов конструкторской документации на магниточувствительные микросистемы для применения в электронных системах управления приводами, в датчиках положения и потребления, бесконтактных переключателях
51. Разработка базовых технологий радиоэлектронных микросистем механических систем	<u>123,525</u> 80,662	<u>43,274</u> 28,45	<u>80,251</u> 52,212						разработка и освоение в производстве базовых технологий изготовления радиоэлектронных

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
52. Разработка базовых конструкций радиочастотных микроэлектромеханических систем	<u>142,577</u> 96		<u>35,6</u> 25	<u>63,477</u> 42	<u>43,5</u> 29				микроэлектромеханических систем и компонентов, включающих микрореле, коммутаторы, микропереключатели (2009 год)
									разработка базовых конструкций и комплектов конструкторской документации на изготовление радиочастотных микроэлектромеханических систем - компонентов, позволяющих получить резкое улучшение массогабаритных характеристик, повышение технологичности и снижение стоимости изделий
53. Разработка методов и средств обеспечения создания и производства изделий микросистемной техники	<u>38,915</u> 22,8	<u>38,915</u> 22,8							создание методов и средств контроля и измерения параметров и характеристик изделий микросистемотехники,

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
54. Разработка перспективных технологий и конструкций микро-оптоэлектронно-механических систем для оптической аппаратуры, систем отображения изображений, научных исследований и специальной техники	<u>1077</u> 718					<u>345</u> 230	<u>315</u> 210	<u>256,5</u> 171	<u>160,5</u> 107	разработка комплектов стандартов и нормативных документов по безопасности и экологии создание базовых технологий выпуска трехмерных оптических и акустооптических функциональных элементов, микрооптоэлектронно-механических систем для коммутации и модуляции оптического излучения (2012 год), акустооптических перестраиваемых фильтров (2012 год), двухмерных управляемых матриц микрозеркал, микропереключателей и фазовращателей (2013 год), разработка базовых технологий, конструкций и комплектов, конструкторской документации на изготовление

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе								Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
55. Разработка и совершенствование методов и средств контроля, испытаний и аттестации изделий микросистемотехники	<u>791,25</u> 527,5				<u>150</u> 100	<u>262,5</u> 175	<u>142,5</u> 95	<u>112,5</u> 75	<u>123,75</u> 82,5	микрооптоэлектромеханических систем коммутации оптического излучения (2015 год) создание методов и средств контроля и измерения параметров и характеристик изделий микросистемотехники
56. Разработка перспективных технологий и конструкций микроаналитических систем для аппаратуры контроля и обнаружения токсичных, горючих, взрывчатых и наркотических веществ	<u>868,5</u> 579					<u>360</u> 240	<u>253,5</u> 169	<u>156,75</u> 104,5	<u>98,25</u> 65,5	создание перспективных технологий изготовления элементов микроаналитических систем, чувствительных к газовым, химическим и биологическим компонентам внешней среды, предназначенных для использования в аппаратуре жилищно-коммунального хозяйства (2012 год, 2013 год, 2014 год)
Всего по направлению 3	<u>4795,3</u> 3130,63	<u>476,964</u> 306,9	<u>466,233</u> 268,73	<u>442,103</u> 285	<u>465</u> 310	<u>1050</u> 700	<u>986,75</u> 654,5	<u>525,75</u> 350,5	<u>382,5</u> 255	

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	

Направление 4. Микроэлектроника

57. Разработка технологий и развитие методологии проектирования изделий микроэлектроники: разработка и освоение современной технологии проектирования универсальных микропроцессоров, процессоров обработки сигналов, микроконтроллеров и "системы на кристалле" на основе каталогизированных сложнофункциональных блоков и библиотечных элементов, в том числе создание отраслевой базы данных и технологических файлов для автоматизированных систем проектирования, освоение и развитие технологии проектирования для обеспечения технологичности производства и	<u>308,667</u> 178,4	<u>219,3</u> 129,5	<u>89,367</u> 48,9						разработка комплекта нормативно-технической документации по проектированию изделий микроэлектроники, создание отраслевой базы данных с каталогами библиотечных элементов и сложнофункциональных блоков с каталогизированными результатами аттестации на физическом уровне, разработка комплекта нормативно-технической и технологической документации по взаимодействию центров проектирования в сетевом режиме
---	-------------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	---

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
стабильного выхода годных изделий в целях размещения заказов на современной базе контрактного производства с технологическим уровнем до 0,13 мкм										
58. Разработка и освоение базовой технологии производства фотошаблонов с технологическим уровнем до 0,13 мкм в целях обеспечения информационной защиты проектов изделий микроэлектро- ники при использовании контрактного производ- ства (отечественного и зарубежного)	$\frac{34,569}{22,7}$	$\frac{22,7}{14,7}$	$\frac{11,869}{8}$							разработка комплекта технологической документации и организационно- распорядительной документации по взаимодействию центров проектирования и центра изготовления фотошаблонов
59. Разработка семейств и серий изделий микроэлектроники: универсальных микропроцессоров для встроенных приме-	$\frac{852,723}{490,2}$	$\frac{350,836}{190,1}$	$\frac{501,887}{300,1}$							разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год

нений, универсальных микропроцессоров для серверов и рабочих станций, цифровых процессоров обработки сигналов, сверхбольших интегральных схем, программируемых логических интегральных схем, сверхбольших интегральных схем быстросействующей динамической и статической памяти, микроконтроллеров со встроенной энергонезависимой электрически программируемой памятью, схем интерфейса дискретного ввода - вывода, схем аналогового интерфейса, цифроаналоговых и аналого-цифровых преобразователей на частотах выше 100 МГц с разрядностью более 8-12 бит, схем приемо-

производственной документации, изготовление опытных образцов изделий и организация серийного производства

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Ожидаемые результаты		
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год		2014 год	2015 год
передагчиков шинных интерфейсов, изделий интеллектуальной силовой микроэлектро- ники для применения в аппаратуре промышлен- ного и бытового назначения, встроенных интегральных источников питания										
60. Разработка базовых серийных технологий изделий микроэлектроники: цифроаналоговых и аналого-цифровых преобразователей на частотах выше 100 МГц с разрядностью более 14 - 16 бит, микроэлектронных устройств различных типов, включая сенсоры с применением наноструктур и биосенсоров, сенсоров на основе магнито- электрических и пьезоматериалов,	<u>2236,828</u> 1299	<u>1129,878</u> 592,3	<u>971,95</u> 616,7	<u>135</u> 90						разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, изготовление опытных образцов изделий и организация серийного производства

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе								Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	

встроенных
интегральных антенных
элементов для
диапазонов частот
5 ГГц, 10 - 12 ГГц,
систем на кристалле, в
том числе в гетероинтег-
рации сенсорных и
исполнительных
элементов методом
беспроводной сборки с
применением
технологии матричных
жестких выводов

61. Разработка технологий и освоение производства изделий микроэлектроники с технологическим уровнем 0,13 мкм	545,397	304,9	240,497							разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструктор- ской, технологической документации и ввод в эксплуатацию производственной линии
	308,8	168,3	140,5							
62. Разработка базовой технологии формирования многоуровневой разводки (7 - 8 уровней) сверхбольших	939,45	196	360			154	229,45			разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и
	587,3	102	240			99	146,3			

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
интегральных схем на основе Al и Cu									производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии
63. Разработка технологии и организация производства многокристалльных микроэлектронных модулей для мобильных применений с использо- ванием полимерных и металлополимерных микропласт и носителей	<u>519,525</u> 288,9	<u>235,513</u> 101	<u>168,512</u> 110,9	<u>115,5</u> 77					разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструктор- ской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии
64. Разработка новых методов технологичес- ких испытаний изделий микроэлектроники, гарантирующих их повышенную надежность в процессе долговременной (более 100000 часов) эксплуатации, на основе использования типовых оценочных схем и тестовых кристаллов	<u>133,8</u> 133,8	<u>67</u> 67	<u>66,8</u> 66,8						разработка технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию специализированных участков

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
65. Разработка современных методов анализа отказов изделий микроэлектроники с применением ультразвука-разрешающих методов (ультразвуковая гигагерцовая микроскопия, сканирование синхротронным излучением, атомная и туннельная силовая микроскопия, электронно- и ионно-лучевое зондирование и др.)	243,77 243,77	131,9 131,9	111,87 111,87						разработка комплектов документации, включая утвержденные отраслевые методики, ввод в эксплуатацию модернизированных участков и лабораторий анализа отказов	
66. Разработка базовых субмикронных технологических уровней 0,065 - 0,045 мкм	1170,325 773,55					310 200	354,45 236,3	285 190	220,875 147,25	создание технологий сверхбольших интегральных схем, создание базовой технологии формирования многослойной разводки сверхбольших интегральных схем топологического уровня 0,065 - 0,045 мкм (2015 год), освоение и развитие технологии проектирования и

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						2015 год	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	

изготовления для обеспечения технологичности производства и стабильного выхода годных изделий, а также в целях размещения заказов на современной базе контрактного производства с технологическим уровнем до 0,045 мкм, разработка комплекта технологической документации и организационно-распорядительной документации по взаимодействию центров

67. Исследование технологических процессов и структур для субмикронных технологий уровней 0,032 мкм	<u>1372,075</u>	<u>383</u>	<u>383,45</u>	<u>334,875</u>	<u>270,75</u>	создание технологий сверхбольших интегральных схем технологических уровней 65 - 45 нм, организация опытного производства и исследование технологических уровней 0,032 мкм (2015 год)			
	894,45	245	245,7	223,25	180,5				

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
68. Разработка перспективных технологий и конструкций изделий интеллектуальной силовой электроники для применения в аппаратуре бытового и промышленного применения, на транспорте, в топливно-энергетическом комплексе и в специальных системах	<u>1372,376</u> 902,946				<u>166,05</u> 110,7	<u>402,7</u> 261,8	<u>318</u> 212	<u>288,38</u> 192,25	<u>197,246</u> 126,196	создание технологий и конструкций перспективных изделий интеллектуальной силовой микроэлектроники для применения в аппаратуре промышленного и бытового назначения, создание встроенных интегральных источников питания (2013 - 2015 годы)
69. Разработка перспективных технологий сборки сверхбольших интегральных схем в многовыводные корпуса, в том числе корпуса с матричным расположением выводов, и технологий многокристальной сборки, включая создание "систем в корпусе"	<u>1649,14</u> 1072,36				<u>300</u> 200	<u>356,4</u> 224,2	<u>205</u> 123	<u>413,25</u> 275,5	<u>374,49</u> 249,66	разработка перспективной технологии многокристальных микроэлектронных модулей для мобильных применений с использованием полимерных и металлополимерных микроплат и носителей (2015 год)

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе								Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	

Всего по направлению 4 11378,645 1096,636 1257,803 1494,39 1913,5 1741,1 1490,35 1321,505 1063,361
7196,176 701,5 777,17 805,2 1244,4 1120 963,3 881 703,606

Направление 5. Электронные материалы и структуры

70. Разработка технологии производства новых диэлектрических материалов на основе ромбоэдрической модификации нитрида бора и подложек из поликристаллического алмаза	<u>78</u> 49	<u>51</u> 32	<u>27</u> 17							внедрение новых диэлектрических материалов на основе ромбоэдрической модификации нитрида бора и подложек из поликристаллического алмаза с повышенной теплопроводностью и электропроводностью для создания нового поколения высокоэффективных и надежных сверхвысокочастотных приборов
71. Разработка технологии производства гетероэпитаксиальных структур и структур гетеробиполярных транзисторов на основе нитридных соединений A_3B_5 для мощных полупроводниковых	<u>93,663</u> 54,24	<u>46,233</u> 22,62	<u>47,43</u> 31,62							создание технологии производства гетероэпитаксиальных структур и структур гетеробиполярных транзисторов на основе нитридных соединений A_3B_5 для обеспечения разработок и

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год		2014 год
приборов и сверхвысокочастотных монокристаллических интегральных схем									изготовление сверхвысокочастотных монокристаллических интегральных схем и мощных транзисторов (2011 год)
72. Разработка базовой технологии производства метаморфных структур на основе GaAs и псевдоморфных структур на подложках InP для приборов сверхвысокочастотной электроники диапазона 60 - 90 ГГц	<u>78,047</u> 49,8	<u>50,147</u> 32	<u>27,9</u> 17,8						создание базовой технологии производства гетероструктур и псевдоморфных структур на подложках InP для перспективных полупроводниковых приборов и сверхвысоко- частотных монокристаллических интегральных схем диапазона 60 - 90 ГГц (2009 год)
73. Разработка технологии производства спинэлектронных магнитных материалов, радиопоглощающих и мелкодисперсных ферритовых материалов для сверхвысокочас- тотных приборов	<u>132,304</u> 82	<u>33,304</u> 16	<u>45</u> 30	<u>54</u> 36					создание спинэлектронных магнитных материалов и микроволновых структур со спиновым управлением для создания перспективных микроволновых сверхвысокочастотных приборов повышенного

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год		2014 год
74. Разработка технологий производства высокочистых химических материалов (аммиака, арсина, фосфина, тетрахлорида кремния) для обеспечения производства полупроводниковых подложек нитрида галлия, арсенида галлия, фосфида индия, кремния и гетерозип-таксиальных структур на их основе	$\frac{76,4}{47,3}$	$\frac{50,1}{31}$	$\frac{26,3}{16,3}$						быстродействия и низкого энергопотребления
75. Разработка технологий производства поликристаллических алмазов и их пленок для теплопроводных конструкций мощных выходных транзисторов и сверхвысокочастотных приборов	$\frac{62,07}{45,38}$	$\frac{12}{12}$	$\frac{35,07}{23,38}$	$\frac{15}{10}$					создание технологии производства поликристаллических алмазов и их пленок для мощных сверхвысокочастотных приборов (2012 год)

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
76. Исследование путей и разработка технологий изготовления новых микроволокон на основе двухмерных диэлектрических и металлодиэлектрических микро- и наноструктур, а также полупроводниковых нитей с наноразмерами при вытяжке стеклянного капилляра, заполненного жидкой фазой полупроводника	<u>57</u> 38	<u>36</u> 24	<u>21</u> 14						создание технологий изготовления новых микроволокон на основе двухмерных диэлектрических и металлодиэлектрических микро- и наноструктур для новых классов микроструктурных приборов, магниторезисторов, осцилляторов, устройств оптоэлектроники (2009 год)
77. Разработка технологий выращивания слоев пьезокерамики на кремниевых подложках для формирования комплексированных устройств микросистемной техники	<u>64,048</u> 39		<u>4,5</u> 3	<u>32,548</u> 18	<u>27</u> 18				создание базовой пленочной технологии пьезокерамических элементов, совместимой с комплементарной металлооксидной полупроводниковой технологией для разработки нового класса активных пьезокерамических устройств, интегрированных с микросистемами (2011 год)

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
78. Разработка методологии и базовых технологий создания многослойных кремниевых структур с использованием "жертвенных" и "стопорных" диффузионных и диэлектрических слоев для производства силовых приборов и элементов микроэлектромеханических систем	<u>63,657</u> 38	<u>42,657</u> 24	<u>21</u> 14						создание технологий травления и изготовления кремниевых трехмерных базовых элементов микроэлектромеханических систем с использованием "жертвенных" и "стопорных" слоев для серийного производства элементов микро-электромеханических систем (2009 год) кремниевых структур с использованием силикатных стекол, моно-, поликристаллического и пористого кремния и диоксида кремния
79. Разработка базовых технологий получения алмазных полупроводниковых наноструктур и наноразмерных органических покрытий с широким диапазоном	<u>45,85</u> 22			<u>29,35</u> 11	<u>16,5</u> 11				создание технологий получения алмазных полупроводниковых наноструктур и наноразмерных органических покрытий, алмазных полупроводящих пленок

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Ожидаемые результаты		
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год		2014 год	2015 год
функциональных свойств										для конкурентоспособ- ных высоко- температурных и радиационно стойких устройств и приборов двойного назначения (2011 год)
80. Исследование и разработка технологии роста эпитаксиальных слоев карбида кремния, структур на основе нитридов, а также формирования изолирующих и коммутирующих слоев в приборах экстремаль- ной электроники	<u>136,716</u> 88,55	<u>57,132</u> 38	<u>79,584</u> 50,55							создание технологии изготовления гетероструктур и эпитаксиальных структур на основе нитридов для создания радиационно стойких сверхвысоко- частотных и силовых приборов нового поколения (2009 год)
81. Разработка технологии производства радиационно стойких сверхбольших интегральных схем на ультратонких гетероэпитаксиальных структурах кремния на сапфировой подложке для производства	<u>159,831</u> 90	<u>52</u> 35	<u>107,831</u> 55							создание технологии производства структур "кремний на сапфире" диаметром до 150 мм с толщиной приборного слоя до 0,1 мкм и топологическими нормами до 0,18 мкм для производства электронной

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
электронной компонентной базы специального и двойного назначения									компонентной базы специального и двойного назначения (2009 год)
82. Разработка технологий производства высокоомного радиационно облученного кремния, слитков и пластин кремния диаметром до 150 мм для производства силовых полупроводниковых приборов	<u>138,549</u> 89,7	<u>54</u> 36	<u>84,549</u> 53,7						создание технологии производства радиационно облученного кремния и пластин кремния до 150 мм для выпуска мощных транзисторов и силовоточных тиристоров нового поколения (2009 год)
83. Разработка технологий производства кремниевых подложек и структур для силовых полупроводниковых приборов с глубокими высоколегированными слоями р- и n-типов проводимости и скрытыми слоями носителей с повышен- ной рекомбинацией	<u>90,4</u> 58,9	<u>38,5</u> 24	<u>51,9</u> 34,9						разработка и промыш- ленное освоение получе- ния высококачественных подложек и структур для использования в производстве силовых полупроводниковых приборов с глубокими высоколегированными слоями и скрытыми слоями носителей с повышенной рекомби- нацией (2009 год)

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
84. Разработка технологий производства электронного кремния, кремниевых пластин диаметром до 200 мм и кремниевых эпитаксиальных структур уровня технологии 0,25 - 0,18 мкм	<u>220,764</u> 162	<u>73,964</u> 48	<u>146,8</u> 114						создание технологии производства пластин кремния диаметром до 200 мм и эпитаксиальных структур уровня 0,25 - 0,18 мкм (2009 год)
85. Разработка методологии, конструктивно-технических решений и перспективной базовой технологии корпусирования интегральных схем и полупроводниковых приборов на основе использования многослойных кремниевых структур со сквозными токопроводящими каналами	<u>266,35</u> 161			<u>81,85</u> 38	<u>124,5</u> 83	<u>30</u> 20	<u>30</u> 20		разработка технологии корпусирования интегральных схем и полупроводниковых приборов на основе использования многослойных кремниевых структур со сквозными токопроводящими каналами, обеспечивающей сокращение состава сборочных операций и формирование трехмерных структур (2013 год)
86. Разработка технологий производства гетероструктур SiGe для	<u>230,141</u> 143			<u>35,141</u> 13	<u>135</u> 90	<u>30</u> 20	<u>30</u> 20		создание базовой технологии производства гетероструктур SiGe для

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
разработки сверх- больших интегральных схем с топологическими нормами 0,25 - 0,18 мкм									выпуска быстродействующих сверхбольших интегральных схем с топологическими нормами 0,25 - 0,18 мкм (2011 год, 2013 год)
87. Разработка технологий выращивания и обработки, в том числе плазмохимической, новых пьезоэлектрических материалов для акустоэлектроники и акустооптики	<u>46,745</u> 34	<u>28,745</u> 22	<u>18</u> 12						создание технологии выращивания и обработки пьезоэлектрических материалов акустоэлектроники и акустооптики для обеспечения производства широкой номенклатуры акустоэлектронных устройств нового поколения (2009 год)
88. Разработка технологий производства соединений A_3B_5 и тройных структур для производства сверхмощных лазерных диодов,	<u>93,501</u> 58	<u>24,001</u> 12	<u>33</u> 22	<u>23</u> 15	<u>13,5</u> 9				создание технологии массового производства исходных материалов и структур для перспективных приборов лазерной и оптоэлектронной

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
высокоэффективных светодиодов белого, зеленого, синего и ультрафиолетового диапазонов, фотоприемников среднего инфракрасного диапазона									техники, в том числе производства сверхмощных лазерных диодов (2010 год), высокоэффективных светодиодов белого, зеленого, синего и ультрафиолетового диапазонов (2011 год), фотоприемников среднего инфракрасного диапазона (2013 год)
89. Исследование и разработка технологий получения гетероструктур с вертикальными оптическими резонаторами на основе квантовых ям и квантовых точек для производства вертикально излучающих лазеров для устройств передачи информации и матриц для оптоэлектронных переключателей нового поколения	<u>45,21</u> 30	<u>30,31</u> 22	<u>14,9</u> 8						создание технологии производства принципиально новых материалов полупроводниковой электроники на основе сложных композиций для перспективных приборов лазерной и оптоэлектронной техники (2009 год)

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год		2014 год
90. Разработка технологии производства современных компонентов для специализированных фотоэлектронных приборов, в том числе катодов и газопоглотителей, электронно-оптических и отклоняющих систем, стеклооболочек и деталей из электровакуумного стекла различных марок	$\frac{32,305}{17}$			$\frac{24,805}{12}$	$\frac{7,5}{5}$				создание технологии производства компонентов для специализированных электронно-лучевых (2010 год), электронно-оптических и отклоняющих систем (2010 год), стеклооболочек и деталей из электровакуумного стекла различных марок (2011 год)
91. Разработка технологии производства особо тонких гетерированных нанопримесями полупроводниковых структур для высокоэффективных фотокаодов, электронно-оптических преобразователей и фотоэлектронных умножителей, приемников инфракрасного диапазона и солнечных	$\frac{39,505}{32}$	$\frac{27,505}{20}$	$\frac{12}{12}$						создание технологии производства особо тонких гетерированных нанопримесями полупроводниковых структур для изготовления высокоэффективных фотокаодов электронно-оптических преобразователей и фотоэлектронных умножителей, приемников инфракрасного

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
элементов с высокими значениями коэффициента полезного действия									диапазона, солнечных элементов и других приложений (2009 год)
92. Разработка базовой технологии производства монокристаллов AlN для изготовления и изолирующих и проводящих подложек для гетероструктур	$\frac{42,013}{24}$	$\frac{24,013}{12}$	$\frac{18}{12}$						создание технологии монокристаллов AlN для изготовления и изолирующих и проводящих подложек для создания полупроводниковых высокотемпературных и мощных сверхвысокочастотных приборов нового поколения (2011 год)
93. Разработка базовой технологии производства наноструктурированных оксидов металлов (корунда и др.) для производства вакуумно-плотной нанокерамики, в том числе с заданными оптическими свойствами	$\frac{44,599}{29,2}$	$\frac{29,694}{19,85}$	$\frac{14,905}{9,35}$						создание базовой технологии вакуумно-плотной спецстойкой керамики из нанокристаллических порошков и нитридов металлов для промышленного освоения спецстойких приборов нового поколения (2009 год), в том числе микрочипов,

диапазона, солнечных элементов и других приложений (2009 год)

создание технологии монокристаллов AlN для изготовления изолирующих и проводящих подложек для создания полупроводниковых высокотемпературных и мощных сверхвысокочастотных приборов нового поколения (2011 год)

создание базовой технологии вакуумно-плотной спецстойкой керамики из нанокристаллических порошков и нитридов металлов для промышленного освоения спецстойких приборов нового поколения (2009 год), в том числе микрочипов,

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	

94. Разработка базовой технологии производства полимерных и гибридных органических неорганических наноструктурированных защитных материалов для электронных компонентов нового поколения прецизионных и сверхвысокочастотных резисторов, терминаторов, аттенуаторов и резисторно-индукционных емкостных матриц, стойких к воздействию комплекса специальных внешних факторов	<u>25,006</u> 13			<u>22,006</u> 11	<u>3</u> 2				сверхвысокочастотных аттенуаторов, RLC-матриц, а также особо прочной электронной компонентной базы оптоэлектроники и фотоники
									создание технологии производства полимерных и композиционных материалов с использованием поверхностной и объемной модификации полимеров наноструктурированными наполнителями для создания изделий с высокой механической, термической и радиационной стойкостью при работе в условиях длительной эксплуатации и воздействия комплекс специальных внешних факторов (2011 год)

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
95. Исследование и разработка перспективных гетероструктурных и наноструктурированных материалов с экстремальными характеристиками для перспективных электронных приборов и радиоэлектронной аппаратуры специального назначения	<u>1365,875</u> 910,25				<u>225</u> 150	<u>269</u> 179	<u>309</u> 206	<u>306,375</u> 204,25	<u>256,5</u> 171
									создание базовой технологии производства гетероструктур, структур и псевдоморфных структур на подложках InP для переспективных полупроводниковых приборов и сверхвысоко-частотных монокристаллических интегральных схем диапазона 60 - 90 ГГц (2012 год), создание технологии получения алмазных полупроводниковых наноструктур и наноразмерных органических покрытий (2013 год), алмазных полупроводящих пленок для конкурентоспособных высокотемпературных и радиационно-стойких устройств и приборов двойного назначения, создание технологии изготовления гетероструктур и эпитаксиальных структур на основе нитридов (2015 год)

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
96. Исследование и разработка экологически чистых материалов и методов их использования в производстве электронной компонентной базы и радиоаппаратуры, включая бесвинцовые композиции для сборки	<u>1254,0188</u> 836,0125					<u>435</u> 290	<u>300</u> 200	<u>259,5188</u> 173,0125	<u>259,5</u> 173	создание нового класса конструкционных и технологических материалов для уровней технологии 0,065 - 0,032 мкм и обеспечения высокого процента выхода годных изделий, экологических требований по международным стандартам (2012 год, 2015 год)
97. Разработка перспективных технологий получения ленточных материалов (полимерные, металли- ческие, плакированные и другие) для радиоэлектронной аппаратуры и сборочных операций электронной компонентной базы	<u>1333,625</u> 889,75					<u>404</u> 270	<u>352,5</u> 235	<u>292,125</u> 194,75	<u>285</u> 190	создание перспективных технологий производства компонентов для специализированных электронно-лучевых, электронно-оптических и отклоняющих систем, стеклооболочек и деталей из электровакуумного стекла различных марок (2013 год), создание технологии производства полимерных и компози- ционных материалов с использованием

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год

поверхностной и
объемной модификации
полимеров нанострукту-
рированными наполни-
телями (2015 год)

Всего по направлению 5 6316,1928 621,754 658,169 365,251 717 1260 1035 858,0188 801
4131,0825 407,85 431,6 177,62 478 840 690 572,0125 534

Направление 6. Группы пассивной электронной компонентной базы

98. Разработка технологий
выпуска прецизионных
температуроста-
бильных
высокочастотных до
1,5 - 2 ГГц резонаторов
на поверхностно акусти-
ческих волнах до
1,5 ГГц с полосой
до 70 процентов
и длительностью
сжатого сигнала
до 2 - 5 нс

18 12,928
12 8

разработка расширенного
ряда резонаторов с
повышенной
кратковременной и
долговременной
стабильностью для
создания контрольной
аппаратуры и техники
связи двойного
назначения

99. Разработка в
лицензируемых и
нелицензируемых
международных
частотных диапазонах

78,5 32 13,5
45 14 9

создание технологий и
конструкции
акустоэлектронных
пассивных и активных
меток-транспондеров для

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
860 МГц и 2,45 ГГц ряда радиочастотных пассивных и активных акустоэлектронных меток-транспондеров, в том числе работающих в реальной помеховой обстановке, для систем радиочастотной идентификации и систем управления доступом									применения в логистических приложениях на транспорте, в торговле и промышленности (2010 год, 2011 год)
100. Разработка базовой конструкции и промышленной технологии производства пьезокерамических фильтров в корпусах для поверхностного монтажа	<u>30,5</u> 19,5	<u>17</u> 11	<u>13,5</u> 8,5						создание технологии проектирования и базовых конструкций пьезоэлектрических фильтров в малогабаритных корпусах для поверхностного монтажа при изготовлении техники связи массового применения (2009 год)
101. Разработка технологии проектирования, базовой технологии производства и конструирования	<u>37,73</u> 23	<u>37,73</u> 23							создание базовой технологии акустоэлектронных приборов для перспективных систем

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
акустоэлектронных устройств нового поколения и фильтров промежуточной частоты с высокими характеристиками для современных систем связи, включая высокоизбирательные высокочастотные устройства частотной селекции на поверхностных и приповерхностных волнах и волнах Гуляева-Блюштейна с предельно низким уровнем вносимого затухания для частотного диапазона до 5 ГГц									связи, измерительной и навигационной аппаратуры нового поколения - подвижных, спутниковых, тропосферных и радиорелейных линий связи, цифрового интерактивного телевидения, радиоизмерительной аппаратуры, радиолокационных станций, спутниковых навигационных систем (2008 год)
102. Разработка технологий проектирования и базовой технологии производства функциональных законченных устройств стабилизации, селекции частоты и обработки сигналов типа "система в корпусе"	<u>97,416</u> 60,9		<u>35,001</u> 22	<u>62,415</u> 38,9					создание технологий производства высокоинтегрированной электронной компонентной базы типа "система в корпусе" для вновь разрабатываемых и модернизируемых сложных радиоэлектронных систем и комплексов (2010 год)

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
103. Разработка базовой конструкции и технологии изготовления высокочастотных резонаторов и фильтров на объемных акустических волнах для телекоммуникационных и навигационных систем	$\frac{63}{42}$				$\frac{21}{14}$	$\frac{21}{14}$	$\frac{21}{14}$		создание базовой технологии (2013 год) и базовой конструкции микроминиатюрных высокочастотных фильтров для малогабаритной и носимой аппаратуры навигации и связи
104. Разработка технологий и базовой конструкции фоточувствительных приборов с матричными приемниками высокого разрешения для видимого и ближнего инфракрасного диапазона для аппаратуры контроля изображений	$\frac{35}{23}$	$\frac{35}{23}$							создание нового поколения оптоэлектронных приборов для обеспечения задач предотвращения аварий и контроля
105. Разработка базовой технологии унифицированных электронно-оптических преобразователей, микроканальных пластин, пирозлектри-	$\frac{35,309}{21,9}$	$\frac{16,009}{10}$	$\frac{19,3}{11,9}$						создание базовой технологии нового поколения приборов контроля тепловых полей для задач теплоэнергетики, медицины, поисковой и

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год

ческих матриц и камер на их основе с чувствительностью до 0,1 К и широкого инфракрасного диапазона

контрольной аппаратуры на транспорте, продуктопроводах и в охранных системах (2009 год)

106. Разработка базовой технологии создания интегрированных гибридных фотоэлектронных высокочувствительных и высокоразрешающих приборов и усилителей для задач космического мониторинга и специальных систем наблюдения, научной и метрологической аппаратуры

создание базовой технологии (2008 год) и конструкции новых типов приборов, сочетающих фотоэлектронные и твердотельные технологии, в целях получения экстремально достижимых характеристик для задач контроля и наблюдения в системах двойного назначения

107. Разработка базовых технологий мощных полупроводниковых лазерных диодов (непрерывного и импульсного излучения), специализированных лазерных

создание базовой технологии (2008 год) и конструкций принципиально новых мощных диодных лазеров, предназначенных для широкого применения в

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
полупроводниковых диодов, фотодиодов и лазерных волоконно-оптических модулей для создания аппаратуры и систем нового поколения									изделиях двойного назначения, медицины, полиграфического оборудования и системах открытой оптической связи
108. Разработка и освоение базовых технологий для лазерных навигационных приборов, включая интегральный оптический модуль лазерного гироскопа на базе сверхмалогабаритных кольцевых полупроводниковых лазеров инфракрасного диапазона, оптоэлектронные компоненты для широкого класса инерциальных лазерных систем управления движением гражданских и специальных средств транспорта	$\frac{56,5}{37}$	$\frac{16}{10}$	$\frac{30}{20}$	$\frac{10,5}{7}$					разработка базового комплекта основных оптоэлектронных компонентов для лазерных гироскопов широкого применения (2010 год), создание комплекса технологий обработки и формирования структурных и приборных элементов, оборудования контроля и аттестации, обеспечивающих новый уровень технико-экономических показателей производства

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год

109. Разработка базовых конструкций и технологий создания квантово-электронных приемо-передающих модулей для малогабаритных лазерных дальномеров нового поколения на основе твердотельных чип-лазеров с полупроводниковой накачкой, технологических лазерных установок широкого спектрального диапазона	<u>22</u> 15	<u>22</u> 15							создание базовой технологии твердотельных чип-лазеров для лазерных дальномеров, твердотельных лазеров с пикосекундными длительностями импульсов для установок по прецизионной обработке композитных материалов, для создания элементов и изделий микромашиностроения и в производстве электронной компонентной базы нового поколения, мощных лазеров для применения в машиностроении, авиастроении, автомобилестроении, судостроении, в составе промышленных технологических установок обработки и сборки, систем экологического мониторинга окружающей среды,
---	-----------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
110. Разработка базовых технологий формирования конструктивных узлов и блоков для лазеров нового поколения и технологии создания полного комплекта электронной компонентной базы для производства лазерного устройства определения наличия опасных, взрывчатых, отравляющих и наркотических веществ в контролируемом пространстве	<u>66.305</u> 43	<u>56,27</u> 37	<u>10,035</u> 6						контроля выбросов патогенных веществ, контроля утечек в продуктопроводах (2008 год, 2009 год)
									создание технологий получения широкоапертурных элементов на основе алюминотриевой легированной керамики композитных составов для лазеров с диодной накачкой (2008 год), высокоэффективных преобразователей частоты лазерного излучения, организация промышленного выпуска оптических изделий и лазерных элементов широкой номенклатуры
111. Разработка базовых технологий, базовой конструкции и организация производства	<u>35</u> 35	<u>17</u> 17	<u>18</u> 18						разработка расширенной серии низковольтных катодолуминесцентных и других дисплеев с широким диапазоном

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Ожидаемые результаты		
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год		2014 год	2015 год
интегрированных катодолуминес- центных и других дисплеев двойного назначения со встроенным микроэлектронным управлением										эргономических характеристик и свойств по условиям применения для информационных и контрольных систем
112. Разработка технологий и базовых конструкций высокояркостных светодиодов и индикаторов основных цветов свечения для систем подсветки в приборах нового поколения	<u>38,354</u> 29	<u>23,73</u> 16	<u>14,624</u> 13							создание ряда принципиально новых светодиодных приборов с минималь- ными геометрическими размерами, высокой надежностью и устой- чивостью к механичес- ким и климатическим воздействиям, обеспечивающих энергосбережение за счет замены ламп накаливания в системах подсветки аппаратуры и освещения
113. Разработка базовой технологии и конструкции оптоэлектронных приборов (оптроны,	<u>100,604</u> 59		<u>21,554</u> 10	<u>61,05</u> 37	<u>18</u> 12					создание базовой технологии производства нового поколения оптоэлектронной высокоэффективной

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
оптореле, светодиоды) в миниатюрных корпусах для поверхностного монтажа									и надежной электронной компонентной базы для промышленного оборудования и систем связи (2010 год, 2011 год)
114. Разработка схемотехни- ческих решений и унифицированных базовых конструкций и технологий формирова- ния твердотельных видеомодулей на полупроводниковых светодиодах структурах для носимой аппаратуры, экранов индивидуального и коллективного пользования с бесшовной стыковкой	<u>51,527</u> 33,5	<u>24</u> 16	<u>27,527</u> 17,5						создание технологий новых классов носимой и стационарной аппаратуры, экранов отображения информации коллективного пользования повышенных емкости и формата (2009 год)
115. Разработка базовой технологии изготовления высокоэффективных солнечных элементов на базе использования кремния, полученного по "бесхлоридной"	<u>57,304</u> 37	<u>31,723</u> 20	<u>25,581</u> 17						создание технологии массового производства солнечных элементов для индивидуального и коллективного использования в труднодоступных районах, развития

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год		2014 год
технологии и технологии "литого" кремния прямоугольного сечения									солнечной энергетики в жилищно-коммунальном хозяйстве для обеспечения задач энергосбережения (2009 год)
116. Разработка базовой технологии и освоение производства оптоэлектронных реле с повышенными техническими характеристиками для поверхностного монтажа	<u>32</u> 19	<u>18</u> 12	<u>14</u> 7						создание технологии массового производства нового класса оптоэлектронных приборов для широкого применения в радиоэлектронной аппаратуре (2009 год)
117. Комплексное исследование и разработка технологий получения новых классов органических (полимерных) люминофоров, плёночных транзисторов на основе "прозрачных" материалов, полимерной плёночной основы и технологий изготовления	<u>136,7</u> 71,8	<u>50</u> 22	<u>63</u> 34	<u>23,7</u> 15,8					создание базовой технологии массового производства экранов с предельно низкой удельной стоимостью для информационных и обучающих систем (2010 год, 2011 год)

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
крупноформатных гибких и особо плоских экранов, в том числе на базе высокопроизводящих процессоров струйной печати и непрерывного процесса изготовления с катушки на катушку										
118. Разработка базовых конструкций и технологии активных матриц и драйверов плоских экранов на основе аморфных, поликристаллических и кристаллических кремниевых интеграль- ных структур на различных подложках и создание на их основе перспективных видеомодулей, включая органические электро- люминесцентные, жидкокристаллические и катодолуминес- центные, создание базовой технологии	<u>145,651</u> 100,5	<u>45</u> 30	<u>13,526</u> 8,5	<u>87,125</u> 62						создание технологии и конструкций активно- матричных органических электродолуминес- центных, жидкокристаллических и катодолуминесцентных дисплеев, стойких к внешним специальным и климатическим воздействиям (2010 год)

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год		2014 год
серийного производства монолитных модулей двойного назначения									
119. Разработка базовой конструкции и технологии крупноформатных полноцветных газоразрядных видеомодулей	<u>85,004</u> 46	<u>41,004</u> 10	<u>20</u> 20	<u>24</u> 16					создание технологии и базовых конструкций полноцветных газоразрядных видеомодулей специального и двойного назначения для наборных экранов коллективного пользования (2010 год)
120. Разработка технологии сверхпрецизионных резисторов и гибридных интегральных схем цифроаналоговых и аналого-цифровых преобразователей на их основе в металлокера- мических корпусах для аппаратуры двойного назначения	<u>63,249</u> 42	<u>24,013</u> 16	<u>18,027</u> 12	<u>21,209</u> 14					разработка расширенного ряда сверхпрецизионных резисторов, гибридных интегральных схем цифроаналоговых и аналого-цифровых преобразователей с параметрами, превышающими уровень существующих отечественных и зарубежных изделий, для аппаратуры связи, диагностического контроля, медицинского

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
121. Разработка базовой технологии особо стабильных и особо точных резисторов широкого диапазона номиналов, прецизионных датчиков тока для измерительной и контрольной аппаратуры и освоение их производства	<u>72</u> 48				<u>30</u> 20	<u>30</u> 20	<u>12</u> 8		оборудования, авиационные, станкостроения, измерительной техники (2010 год)
									разработка расширенного ряда сверхпрецизионных резисторов с повышенной удельной мощностью рассеяния, высоковольтных высокоомных резисторов для измерительной техники, приборов ночного видения и аппаратуры контроля (2013 год)
122. Разработка базовой и базовых конструкций резисторов и резистивных структур нового поколения для поверхностного монтажа, в том числе резисторов с повышенными характеристиками, ультранизкоомных	<u>149,019</u> 100	<u>10,5</u> 7	<u>18,519</u> 13	<u>24,75</u> 16,5	<u>45</u> 30	<u>50,25</u> 33,5			создание базовой технологии и конструкции резисторов с повышенными значениями стабильности, удельной мощности в чип-исполнении на основе многослойных монокристаллических структур (2010 год, 2013 год)

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
резисторов, малогабаритных подстроечных резисторов, интегральных сборок серии нелинейных полупроводниковых резисторов в многослойном исполнении чип-конструкции									
123. Разработка технологий формирования интегрированных резистивных структур с повышенными техническими эксплуатационными характеристиками на основе микроструктурированных материалов и методов групповой сборки	<u>46,93</u> 30,95	<u>36,001</u> 24	<u>10,929</u> 6,95						
									создание базовой технологии производства датчиков на резистивной основе с высокими техническими характеристиками и надежностью (2009 год)
124. Создание групповой технологии автоматизированного производства толсто пленочных чип- и микрочип-резисторов	<u>59,011</u> 39	<u>30,006</u> 20	<u>29,005</u> 19						
									создание технологии автоматизированного производства чип- и микрочип-резисторов (в габаритах 0402, 0201 и менее) для применения в массовой аппаратуре (2009 год)

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
125. Разработка новых базовых технологий и конструктивных решений изготовления танталовых оксидно-полупроводниковых и оксидно-электролитических конденсаторов и чип-конденсаторов и организация производства конденсаторов с повышенным удельным зарядом, сверхнизким значением внутреннего сопротивления и улучшенными потребительскими характеристиками	<u>126</u> 83	<u>24</u> 16	<u>27</u> 17	<u>75</u> 50					создание базовой технологии производства конденсаторов с качественно улучшенными характеристиками с электродами из неблагородных металлов при сохранении высокого уровня надежности (2010 год)
126. Разработка комплексной базовой технологии и организация производства конденсаторов с органическим диэлектриком и повышенными удельными характеристиками и ионисторов с	<u>29,801</u> 18	<u>22,277</u> 13	<u>7,524</u> 5						создание базовых технологий конденсаторов и ионисторов на основе полимерных материалов с повышенным удельным зарядом и энергоемких накопительных конденсаторов с

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год		2014 год
повышенным током разряда									повышенной удельной энергией (2009 год)
127. Разработка технологий, базовых конструкций высоковольтных (быстродействующих, мощных) вакуумных выключателей нового поколения с предель- ными характеристиками для радиотехнической аппаратуры с высокими сроками службы	<u>94,006</u> 62	<u>23,5</u> 15	<u>39,006</u> 26	<u>31,5</u> 21					создание технологии и базовых конструкций нового поколения выключателей для радиоэлектронной аппаратуры с повышенными тактико- техническими характеристиками и надежностью (2011 год)
128. Разработка технологий создания газонаполненных высоковольтных высокочастотных коммутирующих устройств для токовой коммутации цепей с повышенными техническими характеристиками	<u>50,599</u> 33,5	<u>24,803</u> 16,5	<u>25,796</u> 17						создание технологии изготовления коммутирующих устройств для токовой коммутации цепей в широком диапазоне напряжений и токов для радиоэлектронных и электротехнических систем (2009 год)
129. Разработка полного комплекта электронной компонентной базы для	<u>26,5</u> 17,5	<u>26,5</u> 17,5							создание технологии выпуска устройств грозозащиты в

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
создания модульного устройства грозозащиты зданий и сооружений с обеспечением требований по международным стандартам										индивидуальном, промышленном и гражданском строительстве, строительстве пожароопасных объектов (2008 год)
130. Разработка базовых конструкций и технологий изготовления малогабаритных переключателей с повышенными сроками службы для печатного монтажа	<u>55</u> 37	<u>46</u> 31	<u>9</u> 6							создание базовой технологии формирования высококачественных гальванических покрытий, технологии прецизионного формирования изделий для автоматизированных систем изготовления коммутационных устройств широкого назначения (2009 год)
131. Комплексное исследование и разработка пленочных технологий изготовления высокоэкономичных крупноформатных гибких и особо плоских экранов	<u>741,505</u> 494,67				<u>80,55</u> 53,7	<u>181</u> 121	<u>172,5</u> 115	<u>172,08</u> 114,72	<u>135,375</u> 90,25	комплексное исследование и разработка технологий получения новых классов органических светоизлучающих диодов (ОСИД), полимерной пленочной основы и

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
132. Исследование перспективных конструкций и технологических принципов формирования оптоэлектронных и квантовых структур и приборов нового поколения	<u>740,8875</u> 493,925				<u>75</u> 50	<u>217,5</u> 145	<u>156,75</u> 104,5	<u>171,075</u> 114,05	<u>120,5625</u> 80,375	создание технологий формирования нового поколения оптоэлектронных комплексированных приборов, обеспечивающих создание "системы на кристалле" с оптическими входами-выходами (2014 год, 2015 год)
133. Разработка перспективных технологий промышленного изготовления солнечных высокоэффективных элементов	<u>707,55</u> 471,7					<u>255</u> 170	<u>247,5</u> 165	<u>82,5</u> 55	<u>122,55</u> 81,7	создание перспективной технологии изготовления солнечных элементов на основе четверных соединений нитридов металлов III группы (2015 год)

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	

Всего по направлению 6 4375,9265 688,198 611,262 510,324 352,5 749,5 660 425,655 378,4875
2869,345 456 365,35 336,9 235 500 440 283,77 252,325

Направление 7. Унифицированные электронные модули и базовые несущие конструкции

134. Разработка базовых технологий создания рядов приемопередающих унифицированных электронных модулей для аппаратуры связи, радиолокации, телекоммуникаций, бортовых радиотехнических средств	<u>4141,433</u> <u>2715,25</u>	<u>130,715</u> <u>90,1</u>	<u>167,733</u> <u>113,6</u>	<u>127,015</u> <u>87,7</u>	<u>630</u> <u>420</u>	<u>1058</u> <u>691</u>	<u>707,55</u> <u>471,7</u>	<u>665,7</u> <u>435,3</u>	<u>654,72</u> <u>405,85</u>	создание на основе современной и перспективной отечественной электронной компонентной элементной базы и последних достижений в разработке алгоритмов сжатия видеозображений приемопередающих унифицированных электронных модулей аппаратуры связи, телекоммуникаций, цифрового телевидения, бортовых радиотехнических средств, активных фазированных антенных решеток с параметрами диапазона частот до 100 ГГц, скорости передачи информации до 100 Гбит/с,
--	-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год

создание базовых технологий и конструкции для создания унифицированных рядов приемо-передающих унифицированных электронных модулей аппаратуры волоконно-оптических линий связи когерентных, высокоскоростных каналов со спектральным уплотнением, телекоммуникаций, цифрового телевидения, обеспечивающих импортозамещение в этой области, разработка новых технологий

135. Разработка базовых технологий создания нового класса унифицированных электронных модулей для обработки аналоговых и цифровых сигналов на основе устройств	2961,6528	91,404	159,155	101,29	465	797	706,8	305,675	335,3288	создание на основе базовых технологий и современной отечественной твердотельной компонентной электронной базы унифицированных электронных модулей
	1963,5475	61,1	104,9	56,4	310	540	471,2	196,395	223,5525	

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год

функциональной
электроники, приборов
обработки сигналов
аналого-цифровых и
цифроаналоговых
преобразователей,
сенсоров и
преобразователей

нового поколения для
обработки аналоговых и
цифровых сигналов
радиолокационных
систем и других
радиотехнических систем
в высокочастотных и
сверхвысокочастотных
диапазонах, освоение
производства нового
класса
многофункциональных
радиоэлектронных
устройств, разработка
унифицированных
электронных модулей
преобразователей
физических и
химических величин для
измерения и контроля
широкой номенклатуры
параметров микроме-
ханических систем

136. Разработка базовых
технологий создания
рядов
унифицированных
электронных модулей
для систем телеметрии,

1599,0388 47,185 77,477 63,783 285 453 247,5 199,3275 225,7613
1068,6425 32,5 42,2 45,55 190 313 162 132,885 150,5075

создание рядов
унифицированных
электронных модулей
для систем телеметрии,
управления,
радиолокационных,

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год

управления, навигации (угловых и линейных перемещений, ориентации, стабилизации, позиционирования, наведения, радиопеленгации, единого времени)

робототехнических, телекоммуникационных систем и навигации (ориентации, стабилизации, позиционирования, наведения, радиопеленгации, единого времени), позволяющих резко снизить стоимость и организовать крупное серийное производство радиоэлектронных средств широкого применения

137. Разработка базовых технологий создания рядов унифицированных электронных модулей процессоров, скоростного и сверхскоростного ввода-вывода данных, шифрования и дешифрования данных, интерфейсов обмена, систем сбора и хранения информации, периферийных	<u>3010,4329</u>	<u>60,024</u>	<u>89,053</u>	<u>63,082</u>	<u>540</u>	<u>977</u>	<u>447</u>	<u>433,4324</u>	<u>400,8415</u>	создание на основе современной и перспективной отечественной электронной компонентной базы унифицированных электронных модулей широкой номенклатуры для применения в различных информационных системах, в том числе унифицированных электронных модулей
	1992,1499	40	53,5	42,04	360	658	296	279,9824	262,6275	

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год

устройств, систем
идентификации и
управления доступом,
конверторов,
информационно-
вычислительных систем

шифрования и
дешифрования данных,
разработка базовых
технологий и конструк-
ций унифицированных
электронных модулей
систем радиочастотной
идентификации, систем
идентификации
личности, транспортных
средств, контроля
доступа на объекты
повышенной
безопасности, объектов
атомной энергетики.
В создаваемых
унифицированных
электронных модулях
будет обеспечена
скорость обмена
и передачи информации
до 30 Гб/с

138. Разработка базовых
технологий создания
рядов
унифицированных
электронных цифровых
модулей для
перспективных

разработка на основе
перспективных отече-
ственных сверхбольших
интегральных схем типа
"система на кристалле"
базового ряда электрон-
ных модулей для

1969,3185	49,076	64,824	81,236	270	437	500,9	258,499	307,7835
1312,529	32,7	43,2	46,5	180	303	329,6	172,34	205,189

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год

магистрально-
модульных архитектур

создания перспективных магистрально-модульных архитектур, обеспечивающих создание защищенных средств вычислительной техники нового поколения (автоматизированные рабочие места, серверы, средства высокоскоростных линий волоконной связи), функционирующих с использованием современных высокоскоростных последовательных и параллельных системных интерфейсов

139. Разработка базовых технологий создания ряда унифицированных электронных модулей для контрольно-измерительной, метрологической и поверочной аппаратуры, аппаратуры тестового контроля, диагностики блоков

2029,9439
1347,3459

72,091
35,5

92,753
61,9

61,381
40,8

330
220

536
364

312,9
208,6

318,8432
212,5621

305,9757
203,9838

создание на основе современной и перспективной отечественной электронной компонентной базы рядов унифицированных электронных модулей, обеспечивающих возможность создания по модульному принципу контрольно-измеритель-

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год

радиоэлектронной аппаратуры, для стандартных и встроенных систем контроля и измерений

ной, метрологической и поверочной аппаратуры, аппаратуры тестового контроля и диагностики на основе базовых несущих конструкций, создание комплекта сложнотехнологических блоков, определяющих ядро измерительных приборов, систем и комплексов, разработка законченных функциональных модулей, предназначенных для выполнения процессорных и интерфейсных функций поверки и диагностики сверхбольших интегральных схем "система на кристалле" для систем управления, а также систем проектирования и изготовления модулей систем управления и бортовых электронно-вычислительных машин, систем обработки

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год

140. Разработка базовых технологий создания нового поколения унифицированных рядов средств электропитания и преобразователей электроэнергии для радиоэлектронных систем и аппаратуры гражданского и двойного назначения	2921,0238 1934,6725	<u>58,5</u> 41	<u>95,178</u> 62	<u>91,262</u> 55	<u>480</u> 320	<u>860</u> 574	<u>421,05</u> 280,7	<u>519,3</u> 338,15	<u>395,7388</u> 263,8225	информации и вычислений разработка базовых технологий создания системообразующих унифицированных рядов средств (систем, источников, сервисных устройств) и преобразователей электроэнергии нового поколения межвидового и междоместного применения, в том числе средств электропитания с высокой плотностью упаковки элементов с применением бескорпусных изделий, плоских моточных изделий пленочной технологии, новых методов экранирования, отвода и рассеяния тепла, основанных на применении наноразмерных материалов с высокой анизотропной теплопроводностью. Будут разработаны
---	------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------------	------------------------	-----------------------------	--

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
141. Разработка оптимизированной системы базовых несущих конструкций первого, второго и третьего уровней для наземной, морской, авиационной и космической радиоэлектронной аппаратуры специального и двойного назначения,	2731,3303 1809,5588	43 28	84,225 54,5	90 57	525 350	920 612	424 295	289,9995 193,333	355,1058 219,7258
									разработка системы базовых несущих конструкций, изготавливаемых на основе прогрессивных технологий и обеспечивающих техническую совместимость со всеми видами современных объектов с использованием композиционных
									базовые технологии создания унифицированных рядов источников электропитания, преобразователей электрической энергии, источников и систем бесперебойного электропитания, фильтров сетевых модулей автоматического переключения каналов, модулей защиты от сетевых помех, адаптеров

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год

предназначенной для жестких условий эксплуатации, в том числе работающей в негерметизированном отсеке с использованием прогрессивных технологий

материалов. Применение оптимизированных базовых несущих конструкций позволит сократить сроки разработки радиоэлектронной аппаратуры в 1,2 раза, снизить трудоемкость изготовления базовых несущих конструкций в 1,5 - 2 раза, на 25 процентов уменьшить материалоёмкость и сократить затраты на производство радио-электронной аппаратуры в 1,2 - 1,3 раза, обеспечить эффективное импортозамещение

142. Разработка базовых технологий комплексно интегрированных базовых несущих конструкций с функциями контроля, диагностики, индикации функционирования

2191,264
1463,93

46,16
33

66,651
45,3

60,078
41,38

285
190

482
320

403,8
269,2

421,575
281,05

426
284

разработка системы базовых несущих конструкций, изготавливаемых на основе прогрессивных технологий и обеспечивающих техническую совместимость со всеми

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
										видами современных объектов с использованием композиционных материалов. Применение оптимизированных базовых несущих конструкций позволит сократить сроки разра- ботки радиоэлектронной аппаратуры в 1,2 раза, снизить трудоемкость изготовления базовых несущих конструкций в 1,5 - 2 раза, на 25 процентов умень- шить материалоемкость и сократить затраты на производство радио- электронной аппаратуры в 1,2 - 1,3 раза, обеспечить эффективное импортозамещение
143. Разработка базовых технологий создания облегченных паяных базовых несущих конструкций для радиоэлектронной	<u>1123,518</u> 746	<u>30,618</u> 20	<u>34,2</u> 22,2	<u>38</u> 24	<u>210</u> 140	<u>362</u> 240	<u>185</u> 124	<u>119,7</u> 79,8	<u>144</u> 96	обеспечение улучшения массогабаритных характеристик бортовой аппаратуры на 10 процентов и повышение прочности

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год

аппаратуры авиационного и космического базирования на основе существующих и перспективных алюминиевых сплавов повышенной прочности, обеспечивающих отвод тепла по элементам конструкции

при внешних воздействиях в 1,2 раза

144. Разработка контейнерных базовых несущих конструкций с унифицированными интерфейсными средствами для комплексирования бортовых и наземных систем и комплексов различного назначения	<u>965,425</u> <u>637,75</u>	<u>21</u> 14	<u>32,4</u> 20,4	<u>38</u> 24	<u>180</u> 120	<u>275</u> 180	<u>144</u> 96	<u>139,65</u> 93,1	<u>135,375</u> 90,25	повышение уровня системной интеграции и комплексирования средств и систем, повышение конкурентоспособности не менее чем в 2 раза, обеспечение функционирования аппаратуры в условиях внешних жестких воздействий
---	---------------------------------	-----------------	---------------------	-----------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------------	-------------------------	--

Всего по направлению 7	<u>25644,3758</u> 16991,3761	<u>649,773</u> 427,9	<u>963,649</u> 623,7	<u>815,127</u> 520,37	<u>4200</u> 2800	<u>7157</u> 4795	<u>4500,5</u> 3004	<u>3671,7016</u> 2114,8975	<u>3686,6253</u> 2405,5086	
------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------------	-------------------------------	--

Направление 8. Типовые базовые технологические процессы

145. Разработка технологий изготовления	<u>2826,375</u> 1893,5	<u>45</u> 30	<u>75,057</u> 50	<u>66,568</u> 44	<u>555</u> 370	<u>848</u> 575	<u>407,4</u> 271,6	<u>434,625</u> 289,75	<u>394,725</u> 263,15	обеспечение разработки технологий
---	---------------------------	-----------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------------

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе								Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	

высокоплотных
теплонануженных и
сильноточных печатных
плат

производства печатных
плат 5-го и выше классов
точности, включая платы
со встроенными
пассивными элементами,
создания межслойных
соединений с переход-
ными сопротивлениями
до 1 мОм для силовых
цепей электропитания,
формирования слоев
меди (в том числе с
толщиной
до 200 - 400 мкм),
серебра, никеля с
высокими показателями
проводимости,
формирования
финишных покрытий для
бесвинцовой
технологии производства
изделий,
производства
многослойных печатных
плат под высокие
температуры пайки,
лазерных процессов
изготовления печатных
плат,
прямой металлизации

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год

146. Разработка технологии изготовления прецизионных коммутационных плат на основе керамики (в том числе низкотемпературной), металла, углепластика и других функциональных материалов	<u>1829,852</u> 1221,5	<u>35,733</u> 25	<u>52,195</u> 35	<u>49,124</u> 33,3	<u>360</u> 240	<u>545</u> 363	<u>271,95</u> 181,3	<u>260,775</u> 173,85	<u>255,075</u> 170,05	сквозных и глухих отверстий обеспечение разработки технологий изготовления коммутационных плат для жестких условий эксплуатации и широкого диапазона частот, получения коммутационных плат с температурным коэффициентом расширения, соответствующим тепловым характеристикам многовыводных корпусов (в том числе керамических) современных приборов, обеспечения предельно минимального газовыделения в замкнутом пространстве герметичных модулей, снижения энергоемкости технологических процессов за счет применения прогрессивных материалов и методов обработки, в том числе низкотемпературной
--	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------	---

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год

керамики,
интеграции в
коммутационную плату
тепlostоков и низкоом-
ных проводников,
пассивных элементов,
прогрессивных методов
формообразования
элементов
коммутационных плат,
обеспечения
совмещенного монтажа
компонентов методами
пайки и сварки на одной
плате

147. Разработка технологий сборки, монтажа электронных модулей, многокристалльных модулей и микросборок на основе новой компонентной базы, перспективных технологических и конструкционных материалов	<u>3385,67</u>	<u>65,121</u>	<u>107,805</u>	<u>67,219</u>	<u>615</u>	<u>1033</u>	<u>547,05</u>	<u>503,025</u>	<u>447,45</u>
	2247,95	43	63	44,6	410	689	364,7	335,35	298,3
обеспечение разработки технологий новых методов присоединения, сварки, пайки, в том числе с применением бесвинцовых припоев, высокоточного дозирования материалов, применяемых при сборке (флюсы, припой и припойные пасты, клеи, лаки, компаунды и др.), новых методов сборки и пайки корпусов типа									

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе								Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	

BGA, CSP, Flip-chip и других на различные коммутационные платы, монтажа новой электронной компонентной базы, в том числе бескорпусных кристаллов силовых ключей на токовые шины, сборки и монтажа низкопрофильных магнитных компонентов, настройки и ремонта сложных модулей, в том числе демонтажа и повторного монтажа многослойных компонентов с восстановлением влагозащиты

148. Разработка технологий создания межблочных соединений для коммутации сигналов в широком диапазоне частот и мощностей	<u>1282,8213</u>	<u>29</u>	<u>36,5</u>	<u>36,5</u>	<u>225</u>	<u>382</u>	<u>206,07</u>	<u>192,9713</u>	<u>174,78</u>
	854,5475	19	24	24	150	255	137,38	128,6475	116,52

обеспечение разработки технологий изготовления антенно-фидерных устройств, в том числе гибких волноводов, вращающихся сочленений с различными видами охлаждения, оптоволоконной

149. Разработка методов, средств и технологий автоматизированного контроля коммутационных плат, узлов, электронных модулей и приборов специального и общего применения на этапах разработки и производства	2016,3248	35,154	61,38	47,258	225	382	379,05	451,6613	434,8215	повышение процента выхода годных изделий, снижение потерь на 15 - 30 процентов, обеспечение разработки неразрушающих методов контроля качества монтажных соединений и многослойных структур за счет использования различного излучения и цифровой обработки информации,
	1344,1885	23	41	31,5	150	255	252,7	301,1075	289,881	

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год

150. Разработка технологий производства специальных технологических и конструктивных материалов и базовой технологии защиты электронных модулей от воздействия в жестких условиях эксплуатации	3339,1998 2181,3625	57,178 36	81,504 53,15	73,524 48,97	600 400	1037 658	535,35 356,9	506,95 329,88	447,6938 298,4625	методов выявления напряженных состояний элементов конструкции и потенциальных неисправностей изделий
										импортозамещение специальных конструктивных и технологических материалов, обеспечивающих процессы бесвинтовой и комбинированной пайки, изготовления коммутационных плат, разработка влагозащитных электроизоляционных покрытий с минимальным газовыделением со сроком эксплуатации 25 и более лет, разработка быстроотверждающихся, эластичных, с низким газовыделением в вакууме клеев, компаундов, разработка материалов и технологий их примене-

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год

ния для формирования
 теплосток в высоко-
 плотной аппаратуре,
 разработка
 высокоэффективных
 ферритов для планарных
 трансформаторов
 повышенной мощности,
 обеспечение разработки
 технологий локальной
 защиты чувствительных
 компонентов, общей
 защиты модулей органи-
 ческими материалами, в
 том числе
 наноструктурирован-
 ными,
 изготовление вакуумно-
 плотных корпусов
 многокристалльных
 модулей и микросборок
 под поверхностный
 монтаж на платы,
 формирование покрытий,
 обеспечивающих
 длительную защиту от
 дестабилизирующих
 факторов внешней среды,
 включая ионизирующие
 излучения,

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	

нанесение локальных
покрытий с заданными
свойствами на элементы
конструкций модулей

Всего по направлению 8 14680,2428 267,186 414,441 340,193 2580 4227 2346,87 2350,0075 2154,5453
9743,0485 176 266,15 226,37 1720 2795 1564,58 1558,585 1436,3635

Направление 9. Развитие технологий создания радиоэлектронных систем и комплексов

151. Разработка технологий создания систем и оборудования автоматизации проектирования радиоэлектронных систем и комплексов

создание технологий
отечественного
программно-аппаратного
обеспечения и средств
разработки для
автоматизированного
проектирования
радиоэлектронного
оборудования с исполь-
зованием различных
технологических
процессов,
повышение качества и
сокращение сроков
разработки
радиоэлектронной
продукции,
создание технологий
обеспечения информа-
ционной безопасности

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год

функционирования
 информационно-
 управляющих систем,
 существенное
 повышение уровней
 защиты информации в
 информационно-
 управляющих системах,
 создание базовых уни-
 версальных функци-
 ональных модулей
 защиты информации от
 несанкционированного
 доступа, вирусных атак,
 средств разведки и
 считывания информации,
 криптозащиты каналов
 систем, реализация
 полного технологичес-
 кого цикла проекти-
 рования, испытаний и
 производства
 унифицированной
 высокоэффективной,
 импортозамещающей,
 конкурентоспособной
 аппаратуры

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год

152. Разработка технологий моделирования сложных информационно-управляющих систем, в том числе систем реального времени	3056,819 2026,45	75,3 49,8	138,5 80	80,194 53,1	525 350	1055 705	429 286	384,75 256,5	369,075 246,05	создание новых способов моделирования, в том числе комбинированного способа моделирования, позволяющего существовать образцом повысить быстродействие вычислений при сохранении точности расчета выходных показателей эффективности, способа операционно-динамического моделирования, снижение сроков разработки и испытаний радиоэлектронной продукции, повышение достоверности математического и имитационного моделирования радиоэлектронных систем и комплексов, обеспечение максимальной схожимости результатов с результатами натурных
---	---------------------	--------------	-------------	----------------	------------	-------------	------------	-----------------	-------------------	--

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
153. Разработка технологий полунатурных и стендовых испытаний сложных информационно-управляющих систем	2372,36 1580,068	45,054 30	70,65 45,65	75,029 50	405 270	975 650	285 190	259,4145 172,943	257,2125 171,475
									испытаний и экспериментов
									создание метрологически аттестованной унифицированной стендовой испытательной базы для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, снижение сроков разработки и стоимости испытаний радиоэлектронной продукции, существенное повышение достоверности полунатурного моделирования радиоэлектронных систем и комплексов, обеспечение максимальной сходимости результатов с результатами натурных испытаний
154. Разработка технологий конструирования и производства, а также аппаратно-программного	2212,6825 1472,625	45,05 30	73,65 48,65	68,96 43,96	375 250	907 605	269 179	249,3 166,2	224,7225 149,815
									разработка базовых технологий, элементов и конструкций для создания парка измерительных систем и

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год

обеспечения
метрологических систем
различного назначения
для создания нового
поколения отечест-
венного парка измери-
тельной аппаратуры

приборов, необходимых
для разработки и
испытаний радиотехни-
ческих информационно-
управляющих систем,
систем связи и
телекоммуникаций

Всего по направлению 9 10202,5144 225,436 371,883 305,583 1740 3824 1331,9 1231,7895 1171,9229
6782,2349 149,8 233,3 199,06 1160 2550 887,6 821,193 781,2819

Направление 10. Обеспечивающие работы

155. Разработка
организационных
принципов и научно-
технической базы
обеспечения проекти-
рования и производства
электронной
компонентной базы в
соответствии с требова-
ниями Всемирной
торговой организации

разработка комплекта
методической и научно-
технической докумен-
тации для обеспечения
функционального
систем проектирования и
производства элект-
ронной компонентной
базы в соответствии с
требованиями Всемирной
торговой организации

156. Создание и обеспечение
функционального
систем испытаний
электронной
компонентной базы,

разработка новых и
совершенствование
существующих методов
испытаний электронной
компонентной базы,

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
обеспечивающей поставку изделий с гарантированной надежностью для комплектации систем специального и двойного назначения										разработка методов отбраковочных испытаний перспективной электронной компонентной базы, обеспечение поставки изделий с гарантированной надежностью для комплектации систем специального назначения (атомная энергетика, космические программы, транспорт, системы двойного назначения)
157. Разработка и совершенствование методов, обеспечивающих качество и надежность сложнофункциональной электронной компонентной базы на этапах опытно-конструкторских работ, освоения и производства	<u>94,55</u> 93,05	<u>8,5</u> 7	<u>12</u> 12	<u>9</u> 9	<u>11</u> 11	<u>18</u> 18	<u>10,4</u> 10,4	<u>13,3</u> 13,3	<u>12,35</u> 12,35	разработка и систематизация методов расчетно-экспериментальной оценки показателей надежности электронной компонентной базы, разрешенной для применения в аппаратуре, функционирующей в специальных условиях и с длительными сроками активного существования
158. Создание и внедрение основополагающих	<u>92,2175</u> 83,7175	<u>10</u> 7	<u>14,5</u> 9		<u>10</u> 10	<u>18</u> 18	<u>15</u> 15	<u>12,985</u> 12,985	<u>11,7325</u> 11,7325	разработка системы технологий обеспечения

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		2015 год
документов по обеспечению жизненного цикла изделия на этапах проектирования, производства, применения и утилизации электронной компонентной базы										жизненного цикла изделия при создании широкой номенклатуры электронной компонентной базы
159. Научное сопровождение Программы, в том числе определение технологического и технического уровней развития отечественной и импортной электронной компонентной базы на основе их рубежных технико-экономических показателей, разработка "маршрутных карт" развития групп электронной компонентной базы	<u>131,1825</u> 120,1825	<u>19</u> 13	<u>25</u> 20	<u>15</u> 15	<u>19</u> 19	<u>18</u> 18	<u>10</u> 10	<u>13,3</u> 13,3	<u>11,8825</u> 11,8825	оптимизация состава выполняемых комплексов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по развитию электронной компонентной базы в рамках Программы и определение перспективных направлений создания новых классов электронной компонентной базы с установлением системы технико-экономических и рубежных технологических показателей, разработка "маршрутных карт" развития по направлениям электронной

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
160. Создание интегрированной информационной аналитической автоматизированной системы по развитию электронной компонентной базы, охватывающей деятельность заказчика координатора, заказчика и организаций, участвующих в выполнении комплекса программных мероприятий, в целях оптимизации состава участников, финансовых средств, перечислений государственной прибыли и достижения заданных технико-экономических показателей разрабатываемой электронной компонентной базы	<u>101,0325</u> 94,5325	<u>11</u> 7	<u>14,5</u> 12	<u>9</u> 9	<u>10</u> 10	<u>18</u> 18	<u>13</u> 13	<u>13,3</u> 13,3	<u>12,2325</u> 12,2325
									компонентной базы проведение технико-экономической оптимизации выполнения комплексных годовых мероприятий подпрограммы, создание системы действенного финансового и технического контроля выполнения Программы
161. Определение перспектив развития российской электронной	<u>96,1825</u> 89,1825	<u>11</u> 7	<u>13</u> 10	<u>8</u> 8	<u>8</u> 8	<u>18</u> 18	<u>13</u> 13	<u>13,3</u> 13,3	<u>11,8825</u> 11,8825
									формирование системно-ориентированных материалов по

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
компонентной базы на основе анализа динамики сегментов мирового и отечественного рынков радиоэлектронной продукции и действующей производственно- технологической базы									экономике, технологиям проектирования и производству электрон- ной компонентной базы, обобщение и анализ мирового опыта для выработки технически и экономически обоснованных решений развития электронной компонентной базы
162. Системный анализ результатов выполнения комплекса мероприятий Программы на основе создания отраслевой системы планирования и учета развития разработки, производ- ства и применения электронной компонентной базы по основным технико- экономическим показателям	<u>73</u> 68	<u>11</u> 8	<u>13</u> 11	<u>8</u> 8	<u>7</u> 7	<u>14</u> 14	<u>6,7</u> 6,7	<u>6,65</u> 6,65	<u>6,65</u> 6,65
Всего	<u>801,335</u>	<u>95,8</u>	<u>118</u>	<u>69</u>	<u>94</u>	<u>140</u>	<u>93,1</u>	<u>98,77</u>	<u>92,665</u>
по направлению 10	<u>755,535</u>	<u>68</u>	<u>100</u>	<u>69</u>	<u>94</u>	<u>140</u>	<u>93,1</u>	<u>98,77</u>	<u>92,665</u>
Всего по разделу I	<u>93717,7693</u> 61861,2257	<u>6035,127</u> 3980	<u>6598,632</u> 4241,3	<u>6044,117</u> 3637	<u>14895</u> 9930	<u>22517,65</u> 15024,12	<u>14446,17</u> 9630,78	<u>12070,1494</u> 8037,4007	<u>11110,9239</u> 7380,625

II. Капитальные вложения

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год				
		2014 год	2015 год								
1. Минпромторг России											
163. Реконструкция и техническое переворужение производства сверхвысокочастот- ной техники федерального государственного унитарного пред- приятия "Научно- производственное предприятие "Исток", г. Фрязино, Московская область	<u>744,5</u> 696,5	<u>357</u> 315	<u>191,5</u> 191,5	<u>196</u> 190				2008 - 2010	5293	создание производ- ственно-технологи- ческого комплекса по выпуску твердо- тельных сверхвы- сокочастотных субмодулей мощностью 100 тыс. штук в год	
164. Реконструкция и техническое переворужение федерального государственного унитарного пред- приятия "Научно- производственное предприятие "Пульсар", г. Москва	<u>815,5</u> 580,5	<u>124,5</u> 110	<u>170,5</u> 170,5	<u>100,5</u> 90	<u>420</u> 210			2008 - 2011	3424,4	создание производственной технологической линии по выпуску сверхвысоко- частотных прибо- ров и модулей на широкозонных полупроводниках мощностью 360 тыс. штук в год	

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе					Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год			
165. Реконструкция и техническое переворужение федерального государственного унитарного предприятия "Научно- производственное предприятие "Салют", г. Нижний Новгород	<u>233</u> 140			<u>53</u> 50	<u>180</u> 90		2010 - 2011	3380	расширение мощностей по производству активных элемен- тов и сверхвысоко- частотных монокристаллов интегральных схем с повышенной радиационной стойкостью с 15 до 35 тыс. штук в год
166. Техническое переворужение федерального государственного унитарного предприятия "Научно- производственное предприятие "Алмаз", г. Саратов	<u>193,6</u> 140			<u>93,6</u> 90	<u>100</u> 50		2010 - 2011	3058,73	ввод новых мощностей по производству новейших образцов ламп бегущей волны и других сверхвысоко- частотных приборов, в том числе в миллиметровом диапазоне
167. Реконструкция и техническое переворужение	<u>348,8</u> 200			<u>78,8</u> 65	<u>270</u> 135		2010 - 2011	1438	реконструкция производственной линии по выпуску

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
федерального государственного унитарного предприятия "Научно- производственное предприятие "Торий", г. Москва										новых сверхмощ- ных сверхвысоко- частотных прибо- ров с повышенным уровнем техничес- ких параметров, надежности и долговечности мощностью 88 штук в год
168. Техническое переворужение федерального государственного унитарного предприятия "Новосибирский завод полупровод- никовых приборов с ОКБ", г. Новосибирск	$\frac{100}{60}$		$\frac{40}{30}$	$\frac{60}{30}$				2010 - 2011	1380	реконструкция производственной линии для выпуска новых изделий радиационно стойкой электрон- ной компонентной базы, необходимой для организаций Госкорпорации "Росатом" и Роскосмоса
169. Техническое переворужение федерального государственного унитарного	$\frac{133}{90}$		$\frac{53}{50}$	$\frac{80}{40}$				2010 - 2011	1973	создание производственных мощностей по выпуску радиа- ционно стойкой

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
предприятия "Научно- производственное предприятие "Восток", г. Новосибирск										электронной компонентной базы в количестве 80 - 100 тыс. штук в год для комплек- тования важней- ших специальных систем
170. Техническое переворужение открытого акционерного общества "НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон", г. Москва, г. Зеленоград	<u>1478,06</u> 739,03*					<u>500</u> 250	<u>700</u> 350	<u>278,06</u> 139,03	2012 - 2014	5240 техническое переворужение завода для выпуска сверхбольших интегральных схем с топологическими нормами 0,18 мкм
171. Техническое переворужение федерального государственного унитарного предприятия "Научно- исследовательский институт "Полос"	<u>240</u> 120			<u>49,2</u> 24,6	<u>190,8</u> 95,4			2010 - 2011	2411	организация участка прецизион- ной оптической и механической обработки деталей для лазерных излучателей, твердотельных лазеров и

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
им. М.Ф.Стельмаха", г. Москва										бескарданных лазерных гироско- пов нового поколе- ния мощностью 442 штуки год
172. Реконструкция и техническое переворужение централизованного производства базовых несущих конструкций на федеральном государственном унитарном предприятии "Производственное объединение "Квант", г. Великий Новгород	<u>166,2</u> 150		<u>166,2</u> 150					2009	7630,4	обеспечение потребности в базовых несущих конструкциях, в том числе импор- тозамещающих, предприятий приборостроения, машиностроения, судостроения и других отраслей промышленности
173. Техническое переворужение федерального государственного унитарного пред- приятия "Научно- исследовательский	<u>62</u> 60		<u>62</u> 60					2009	2404,6	техническое переворужение действующего производства электронной компонентной базы и

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
институт электронно- механических приборов", г. Пенза										микросистемо- техники для создания новых рядов конкуренто- способных изделий электронной техники
174. Техническое переворужение федерального государственного унитарного предприятия "Научно- исследовательский институт электронной техники", г. Воронеж	60,1 30	60,1 30						2008	120	техническое переворужение действующих производственных мощностей по выпуску сверх- больших интегральных схем и мощных сверх- высокочастотных транзисторов с объемом выпуска сверхбольших интегральных схем 50 тыс. штук в год, мощных сверхвысоко- частотных транзисторов 10 тыс. штук в год

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
175. Техническое перевооружение федерального государственного унитарного предприятия "Научно-исследовательский институт физических проблем им. Ф.В.Лукина", г. Москва	<u>160</u> 80					<u>160</u> 80		2012	700	организация серийного производства параметрических рядов мембранных датчиков мощностью 10 млн. штук в год и чувствительных элементов для сканирующей зондовой микроскопии мощностью 0,3 млн. штук в год
176. Реконструкция и техническое перевооружение производства перспективных тонкостенных антенно-фидерных устройств и волноводных трактов сверхвысокочастотного диапазона в открытом акционерном	<u>793,22</u> 396,61	<u>64</u> 32		<u>180</u> 90	<u>490</u> 245	<u>59,22</u> 29,61		2010 - 2013	12900	расширение производства перспективных тонкостенных антенно-фидерных устройств и волноводных трактов сверхвысокочастотного диапазона, увеличение выпуска в 1,5 раза мощностью 44,76 тыс. штук в

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
обществе "Рыбинский завод приборостроения", г. Рыбинск, Ярославская область										год
177. Техническое переворужение в целях создания отраслевого информационно- аналитического центра в открытом акционерном обществе "Центральный научно-исследова- тельский институт экономики, систем управления и информации "Электроника", г. Москва	<u>120</u> 60*						<u>40</u> 20	<u>80</u> 40	2013 - 2014	информационно- аналитическое обеспечение деятельности организаций радиоэлектронной промышленности
178. Техническое переворужение и реконструкция производства	<u>1663,86</u> 831,93					<u>1460</u> 730	<u>203,86</u> 101,93		2012 - 2013	повышение эффективности, надежности и конкуренто-

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
и лабораторной базы для разработки и производства перспективных радиоэлектронных модулей, изделий в открытом акционерном обществе "Концерн радиостроения "Вега", г. Москва											способности отечественных радиоэлектронных модулей, изделий, комплексов и систем открытого акционерного общества "Концерн радиостроения "Вега"
179. Техническое переворужение в целях создания отраслевого информационно- аналитического центра по проектированию радиоэлектронных производств в открытом акционерном обществе "Мосэлектрон- проект", г. Москва	<u>540</u> 270						<u>200</u> 100	<u>340</u> 170	2013 - 2014	3000	разработка и внедрение современных технологий проектирования радиоэлектронных производств на базе прогрессивных аппаратно- программных средств автома- тизированного проектирования, в основе которых лежит информа- ционное

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
180. Техническое перевооружение для создания нового поколения радиоэлектронных модулей в открытом акционерном обществе "Научно-производственное предприятие "Рубин", г. Пенза	<u>297,66</u> 148,66	<u>47,66</u> 23,66	<u>110</u> 55	<u>140</u> 70						моделирование зданий** создание комплексного испытательного стенда для исследования образцов техники мощностью 800 штук в год
181. Техническое перевооружение производственно-технологической, контрольно-испытательной базы в открытом акционерном обществе "Инженерно-маркетинговый центр Концерта "Вега", г. Москва	<u>379,9</u> 200*	<u>25,9</u> 23	<u>70</u> 35	<u>80</u> 40	<u>60</u> 30	<u>72</u> 36	<u>72</u> 36	2010 - 2015	996,3	производство систем радиочастотной ** идентификации

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реализации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год				2014 год
182. Строительство лабораторно-производственного комплекса по выпуску перспективных многофункциональных электронных модулей в открытом акционерном обществе "Концерн радиостроения "Вега", г. Москва	$\frac{3200}{1600}^*$						$\frac{1080}{540}$	$\frac{1202}{672}$	$\frac{918}{388}$	2013 - 2015	создание нового высокотехнологичного лабораторно-производственного комплекса для выпуска многофункциональных радиоэлектронных узлов, блоков и приборов на основе СнК, МИС, встраиваемых пассивных компонентов и технологий высокоплотного монтажа. Обеспечение разработки и выпуска конкурентоспособных изделий, комплексов и систем следующего поколения на основе перспективных производственных технологий, в том числе модулей для

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
183. Реконструкция и техническое первооружение в целях создания специализирован- ного производства гироскопов в отк- рытом акционерном обществе "Ижевский электромехани- ческий завод "Купол", г. Ижевск, Удмуртская Республика	1720 860					500 250	480 240	370 185	2012 - 2015	10735	обработки и передачи сигналов радиолокационных навигационных и посадочных систем, антенных систем дистан- ционного зондиро- вания Земли, мик- ропроцессорных систем управления и контроля гибрид- ных двигателей установок** изготовление гироскопов для перспективных летательных аппаратов**

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
184. Техническое перевооружение и реконструкция специализированного производства унифицированных низкочастотных типовых элементов замены и модулей активных фазированных антенных решеток в открытом акционерном обществе "Марийский машиностроительный завод", г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл	$\frac{1220}{610^*}$				$\frac{380}{190}$	$\frac{360}{180}$	$\frac{240}{120}$	2012 - 2015	4287	изготовление унифицированных твердотельных низкочастотных типовых элементов замены для информационных средств и модулей активных фазированных антенных решеток для локационных систем различного применения, перспективных средств связи и управления воздушным движением**
185. Реконструкция и техническое перевооружение производства унифицированных электронных модулей межвидового применения	$\frac{699,82}{349,91}$	$\frac{140}{70}$			$\frac{380}{190}$	$\frac{179,82}{89,91}$		2011 - 2013	9582	организация производства и внедрение современной технологии с соответствующим переоснащением высокопроиз-

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
на открытом акционерном обществе "Феде- ральный научно- производственный центр "Нижегород- ский научно- исследовательский институт радиотехники", г. Нижний Новгород										водительным оборудованием, увеличение объема ежегодного производства продукции с 2370 млн. рублей в 2007 году до 5028 млн. рублей в 2015 году
186. Техническое переворужение специализиро- ванного производ- ства твердотельных передающих и приемных систем, приемо-передаю- щих модулей активных фазиро- ванных антенных решеток в открытом акционерном обществе "Научно- производственное объединение	$\frac{970}{485^*}$				$\frac{240}{120}$	$\frac{277.62}{138.81}$	$\frac{240}{120}$	$\frac{106.19}{53,095}$	$\frac{106.19}{53,095}$	увеличение объемов производ- ства, повышение качества и надеж- ности твердотель- ных передающих и приемных систем, приемо- передающих модулей активных фазированных антенных решеток L-диапазона для перспективных средств связи и управления

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год				2014 год
"Правдинский радиозавод", г. Балахна, Нижегородская область										воздушным движением**	
187. Техническое перевооружение и реконструкция специализирован- ного производства твердотельных передающих и приемных систем, приемо-переда- ющих модулей активных фазированных антенных решеток в открытом акционер- ном обществе "Научно-производ- ственное объедине- ние "Лианозовский электромехани- ческий завод", г. Москва	1230 615*					360 180	330 165	270 135	270 135	2012 - 2015	увеличение объемов производства, повышение качества и надежности твердотельных передающих и приемных систем, приемо- передающих модулей активных фазированных антенных решеток С- и S-диапазонов волн для перспективных средств связи и управления воздушным движением**

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
188. Техническое перевооружение и реконструкция специализированного производства унифицированных высокочастотных типовых элементов замены в открытом акционерном обществе "Завод "Красное знамя", г. Рязань	$\frac{800}{400}$					$\frac{240}{120}$	$\frac{200}{100}$	$\frac{180}{90}$	$\frac{180}{90}$	изготовление унифицированных твердотельных высокочастотных типовых элементов замены для локационных систем различного применения, перспективных средств связи и управления воздушным движением, увеличение объема производства типовых элементов замены на ** 50 процентов
189. Техническое перевооружение и реконструкция специализированного производства унифицированных рабочих мест операторов информационных	$\frac{960}{480}^*$					$\frac{260}{130}$	$\frac{240}{120}$	$\frac{230}{115}$	$\frac{230}{115}$	увеличение выпуска унифицированных автоматизированных рабочих мест операторов информационных и специального назначения

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
систем в открытом акционерном обществе "Уральское производственное предприятие "Вектор", г. Екатеринбург										управляющих систем в 1,7 раза **
190. Реконструкция и техническое переворужение для создания регионального контрактного производства унифицированных электронных модулей в открытом акционерном обществе "Концерн "Созвездие", г. Воронеж	$\frac{883,70}{441,85}$					$\frac{797,62}{398,81}$	$\frac{86,08}{43,04}$	2012 - 2013	1290	внедрение современных технологий с соответствующим переоснащением высокопроиз- водительным оборудованием для организации контрактного производства
191. Создание лабораторной, технологической и производственной базы для обеспе- чения разработки,	$\frac{2060}{1030}^*$					$\frac{640}{320}$	$\frac{560}{280}$	2012 - 2015	3112	создание конку- рентоспособной продукции мирового уровня, освоение техноло- гий двойного

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
производства и испытаний нового поколения телекоммуника- ционных систем и комплексов в открытом акционерном обществе "Концерн "Созвездие", г. Воронеж										назначения, увеличение объема выпуска изделий до 2 - 2,5 млрд. рублей в год**
192. Реконструкция и техническое первооружение производственно- технологической и лабораторно- испытательной базы на федеральном государственном унитарном предприятии "Калужский электромехани- ческий завод", г. Калуга	<u>194,6</u> 97,3						<u>194,6</u> 97,3	2012	620	создание мощностей по изготовлению спецтехники нового поколения, обеспечивающей защиту специальной информации в информационно- коммуника- ционных системах
193. Техническое первооружение	<u>570</u> 285				<u>110</u> 55	<u>460</u> 230		2011 - 2012	3156	увеличение объема выпуска

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
производства перспективных коротковолновых радиостанций в открытом акционерном обществе "Тамбовский завод "Октябрь", г. Тамбов										продукции в 1,3 - 1,5 раза, повышение качества и конкурентоспособности продукции
194. Реконструкция и техническое перевооружение производства наземной аппаратуры подвижной связи в открытом акционерном обществе "Тамбовский завод "Революционный труд", г. Тамбов	$\frac{350}{175^*}$					$\frac{90}{45}$	$\frac{80}{40}$	$\frac{90}{45}$	2012 - 2015	1390 модернизация производства и внедрение современной технологии с соответствующим переоснащением высокопроизводительного оборудования**
195. Техническое перевооружение производственно-технологической и лабораторно-испытательной базы	$\frac{573,08}{286,54}$					$\frac{280}{140}$	$\frac{93,08}{46,54}$		2011 - 2013	2332,2 ускорение и повышение качества работки мультисервисных сетей ведомственной и

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
в открытом акционерном обществе "Воронежский научно- исследовательский институт "Вега", г. Воронеж										профессиональной связи, ожидаемый экономический эффект 3 млрд. рублей
196. Техническое переворужение лабораторной и производственно- технологической базы нового поколения узлов связи в открытом акционерном обществе "Гамбов- ский научно- исследовательский институт радиотехники "Эфир", г. Тамбов	<u>220</u> 110				<u>220</u> 110			2011	7500	ускорение и повышение качества разработки перспективных программно реализуемых сетей радиосвязи и серии унифицированных электронных модулей для построения указанных сетей
197. Техническое переворужение производства открытого	<u>899,12</u> 449,56*				<u>325</u> 162,5	<u>500</u> 250	<u>74,12</u> 37,06	2012 - 2014	1511,3	создание новых производственных мощностей для выпуска

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
акционерного общества "Российская электроника", г. Москва										перспективной номенклатуры резисторов, в том числе чип-резисторов в объеме 1 млрд. рублей в год
198. Техническое перевооружение в целях создания промышленного производства сложнотехнологических сверхвысокочастотных комплексированных устройств, электронных модулей и блоков бортовой аппаратуры в открытом акционерном обществе "Научно-производственное предприятие "Исток" имени А.И.Шокина, г. Фрязино,	<u>162,394</u> 81,197								<u>162,394</u> 81,197	производственный комплекс по серийному выпуску сложнотехнологических сверхвысокочастотных комплексированных устройств, электронных модулей и блоков бортовой аппаратуры, включая синтетизаторы частот, прямо-передаточные моноблоки, комплексированные приемные усилительные, приемно-преобразовательные и передающие

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
Московская область										
199. Техническое перевооружение в целях создания производства новых электровакуумных приборов в открытом акционерном обществе "Научно-производственное предприятие "Контакт", г. Саратов	<u>161,5</u> 136,5		<u>91,5</u> 76,5	<u>70</u> 60					2009 - 2010	устройства, с объемом производства до 750 комплектов ** блоков в год увеличение объемов производства в 1,5 раза мощностью 4327 штук в год
200. Техническое перевооружение и реконструкция производства по выпуску электровакуумных приборов сверх-высокочастотного диапазона и специального технологи-	<u>178,375</u> 150	<u>50,200</u> 50	<u>70,675</u> 50	<u>57,5</u> 50					2008 - 2010	обеспечение увеличения объема выпуска продукции до 0,8 - 1,2 млрд. рублей в год, увеличения ресурса изделий, создания новых приборов мощностью

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
ческого оборудова- ния в открытом акционерном обществе "Владьинский механический завод", г. Москва										706 штук в год
201. Техническое переворужение для создания сбороч- ного производства электронных модулей с использо- ванием новейшей электронной базы на федеральном государственном унитарном предприятии "Электромеха- нический завод "Звезда", г. Сергиев Посад, Московская область	$\frac{778,62}{389,31}$					$\frac{662,38}{331,19}$	$\frac{116,24}{58,12}$	2012 - 2013	3081,3	создание сборочного производства с использованием микромини- агтурной элементной базы, в том числе микропроцессоров и матриц BGA
202. Реконструкция и техническое переворужение	$\frac{420}{210}^*$					$\frac{140}{70}$	$\frac{100}{50}$	2012 - 2015	2156	увеличение объема выпуска продукции

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
в целях создания контрактного производства электронных моду- лей на федеральном государственном унитарном предприятии "Калужский завод телеграфной аппаратуры", г. Калуга										до 520 млн. рублей в год**
203. Техническое первооружение и реконструкция производства и приборно- измерительной базы на федеральном государственном унитарном предприятии "Таганрогский научно-исследо- вательский институт связи", г. Таганрог, Ростовская область	$\frac{302}{151}^*$					$\frac{80}{40}$	$\frac{70}{35}$	$\frac{76}{38}$	$\frac{76}{38}$	2012 - 2015 внедрение современных технологий, создание комплекса для проведения контроля технологических параметров и испытаний. Увеличение объема выпуска продукции в 1,5 раза **

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
204. Техническое перевооружение и реконструкция производства испытательной базы нового поколения пьезоэлектрических генераторов, фильтров, резонаторов в открытом акционерном обществе "Завод "Метеор", г. Волжский, Волгоградская область	<u>280,24</u> 140,12					<u>155</u> 77,5	<u>125,24</u> 62,62	2012 - 2013	3086	производство полного функционального ряда массовых отечественных микроминиатюрных пьезоэлектрических генераторов, фильтров, резонаторов. Увеличение объема выпуска продукции до 230 - 250 млн. рублей в год
205. Реконструкция и техническое перевооружение научно-производственной и лабораторной базы в открытом акционерном обществе "Научно-производственное объединение	<u>400</u> 200*					<u>120</u> 60	<u>120</u> 60	2012 - 2015	2080,5	расширение производственных площадей выпуска приемопередающих модулей на 2080,5 кв. м **

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
"Радиоэлектроника" имени В.И.Шимко", г. Казань, Республика Татарстан										
206. Техническое первооружение в целях создания контрактного производства унифицированных электронных моду- лей на федеральном государственном унитарном предприятии "Нижегородское научно- производственное объединение имени М.В.Фрунзе", г. Нижний Новгород	$\frac{400}{200}^*$					$\frac{120}{60}$	$\frac{120}{60}$	2012 - 2015	1927	организация контрактной сборки массовой продукции, увеличение объема производства контрактной продукции в 1,8 раза **
207. Техническое первооружение в целях создания контрактного	$\frac{214,453}{150}$	$\frac{79}{60}$	$\frac{135,453}{90}$					2008 - 2009	2300	организация контрактной сборки массовой продукции,

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
производства унифицированных электронных моду- лей на федеральном государственном унитарном предпри- ятии "Омское производственное объединение "Иртыш", г. Омск										увеличение объема производства контрактной продукции в 2,5 раза
208. Техническое переворужение в целях создания промышленного производства многоканальных высоковольтных и низковольтных сильноточных источников вторичного электропитания и модуляторов СВЧ сигналов с высокой плотностью ком- поновки электрон- ных компонентов для бортовой	300 150*									
		90,24 45,12		134,76 67,38		75 37,5	2013 - 2015	1100		производственный комплекс по серийному выпуску многоканальных высоковольтных (ВВИП), низково- льтных (НВИП) сильноточных источников вторичного электропитания и модуляторов СВЧ сигналов с высокой плотностью компо- новки электронных компонентов для бортовой аппарату- ры с объемом

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
аппаратуры на федеральном государственном унитарном пред- приятии "Научно- производственное предприятие "Исток", г. Фрязино, Московская область										производства до 500 комплектов блоков в год**
209. Техническое переворужение в целях создания контрактного производства по изготовлению печатных плат выше 5 класса точности и унифицированных электронных модулей на федеральном государственном унитарном предпри- ятии "Пензенское производственное объединение	<u>1000</u> 500*					<u>380,52</u> 190,26	<u>280</u> 140	<u>169,74</u> 84,87	<u>169,74</u> 84,87	2012 - 2015 обеспечение изготовления печатных плат с новыми финишными покрытиями до 20000 кв. м в год, обеспечение изготовления унифицированных электронных модулей на печатных платах в количестве до 400 тыс. штук в год**

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
"Электроприбор", г. Пенза										
210. Техническое первооружение и реконструкция производства электронных сверхвысоко- частотных модулей на федеральном государственном унитарном предприятии "Нижегородский научно-исследова- тельский приборо- строительный институт "Кварц", г. Нижний Новгород	$\frac{594,16}{297,08}^*$					$\frac{280}{140}$	$\frac{74,16}{37,08}$	$\frac{120}{60}$	$\frac{120}{60}$	2012 - 2015 внедрение современной технологии с соответствующим переоснащением высокопроиз- водительным оборудованием. Увеличение объема выпуска продукции в 1,5 раза **
211. Техническое первооружение и реконструкция производства систем, комплексов и средств защиты информации	$\frac{510}{255}^*$					$\frac{210}{105}$	$\frac{160}{80}$	$\frac{70}{35}$	$\frac{70}{35}$	2012 - 2015 обеспечение разработки, производства и аттестации средств комплексов и систем защиты

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
на федеральном государственном унитарном предпри- ятии "Научно- исследовательский институт автоматики", г. Москва										информации. Увеличение объема выпуска продукции до 0,8 - 1,2 млрд. рублей в 1,2 млрд

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
переворужение производственно- технологической и лабораторно- испытательной базы для создания комплексов средств автоматизации информационно- управляющих сис- тем на федеральном государственном унитарном предприятии "Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследова- тельский институт автоматической аппаратуры им. академика В.С.Семенихина", г. Москва										производства и аттестации комплексов средств автоматизации информационно- управляющих систем. Увеличение объема выпуска продукции до 0,52 млрд. рублей в год **
214. Техническое переворужение с целью создания контрактного производства	300 150*					80 40	70 35	75 37,5	2012 - 2015	5400 организация контрактной сборки массовой продукции. Увеличение объема

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
унифицированных электронных модулей на федеральном государственном унитарном предприятии "Калугаприбор", г. Калуга										производства контрактной продукции в 1,8 раза **
215. Техническое переворужение в целях создания контрактного производства унифицированных электронных модулей на федеральном государственном унитарном предприятии "Ростовский-на- Дону научно- исследовательский институт радиосвязи", г. Ростов-на-Дону	$\frac{300}{150}^*$					$\frac{80}{40}$	$\frac{70}{35}$	$\frac{75}{37,5}$	$\frac{75}{37,5}$	организация контрактной сборки массовой продукции. Увеличение объема производства контрактной продукции в 1,7 раза **

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
216. Техническое перевооружение в целях создания контрактного производства унифицированных электронных модулей на федеральном государственном унитарном предприятии "Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт автоматической аппаратуры им. академика В.С.Семенихина", г. Москва	$\frac{300}{150}^*$					$\frac{80}{40}$	$\frac{70}{35}$	$\frac{75}{37,5}$	2012 - 2015	организация контрактной сборки массовой продукции. Увеличение объема производства контрактной продукции в 2,5 раза
217. Техническое перевооружение в целях создания контрактного производства унифицированных электронных модулей в открытом	$\frac{300}{150}^*$					$\frac{70}{35}$	$\frac{90}{45}$	$\frac{70}{35}$	2012 - 2015	организация контрактной сборки массовой продукции. Увеличение объема производства контрактной продукции

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
акционерном обществе "Курский завод "Маяк", г. Курск										в 2,5 раза **
218. Техническое переворужение в целях создания контрактного производства унифицированных электронных модулей на федеральном государственном унитарном предприятии "Научно- исследовательский институт "Полус" им. М.Ф.Степеляха", г. Москва	$\frac{400}{200}^*$					$\frac{100}{50}$	$\frac{200}{100}$	$\frac{50}{25}$	$\frac{2012}{2015}$	организация контрактной сборки массовой продукции. Увеличение объема производства контрактной продукции в 1,8 раза **
219. Техническое переворужение в целях создания контрактного производства унифицированных	$\frac{300}{150}^*$					$\frac{100}{50}$	$\frac{100}{50}$	$\frac{50}{25}$	$\frac{2012}{2015}$	организация контрактной сборки массовой продукции. Увеличение объема производства

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
электронных моду- лей на федеральном государственном унитарном предпри- ятии "Научно- исследовательский институт телевидения", г. Санкт-Петербург										контрактной продукции в 1,7 раза
220. Техническое перевооружение в целях создания мощностей по вы- пуску источников вторичного электропитания в открытом акцио- нерном обществе "Специальное конструкторско- технологическое бюро по релейной технике", г. Великий Новгород	<u>224,2</u> 112,1					<u>120</u> 60	<u>104,2</u> 52,1		1282	увеличение объема производства в 1,5 раза

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
221. Реконструкция и техническое переворужение производства и испытательной базы широкополосных сверхвысокочастот- ных устройств на федеральном государственном унитарном предприятии "Брянский электромехани- ческий завод", г. Брянск	400 200*					100 50	140 70	80 40	9586,6	увеличение объема производства радиоэлектронных изделий на 170 млн. рублей**
222. Техническое переворужение и реконструкция производственно- испытательных мощностей на федеральном государственном унитарном предприятии "Государственное конструкторское	100 50					100 50			1035	увеличение объема выпуска продукции на 100 млн. рублей. Освоение серийного производства изделий "Орион- ЗМ", "Орион- ЗСМ", "Анализ", "Страж-ПМ" и др.

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
бюро аппаратно- программных средств "Связь", г. Ростов-на-Дону										
223. Техническое переворужение научно-техничес- кого и производст- венного комплексов по выпуску электровакуумных приборов сверхвы- сокочастотного диапазона в открытом акционерном обществе "Российская электроника", г. Москва	800 400*						240 120	2013 - 2015	2285	увеличение объема выпуска продукции до 1,6 млрд. рублей в год в открытом акционерном обществе "Владькинский механический завод", снижение себестоимости ** продукции
224. Техническое переворужение и реконструкция регионального производства базовых несущих конструкций на	178,61 169,8	102,6 100	76,01 69,8					2008 - 2009	2010	увеличение объема выпуска продукции в 2 раза

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
федеральном государственном унитарном предприятии "Научно- производственное предприятие "Полет", г. Нижний Новгород											
225. Техническое первооружение производственной и лабораторно- испытательной базы для выпуска нового поколения электрических соединителей в открытом акционерном обществе "Карачевский завод "Электродеталь", г. Карачев, Брянская область	$\frac{480}{240^*}$						$\frac{380}{190}$	$\frac{50}{25}$	2013 - 2015	2628,6	обеспечение выпуска конку- рентоспособных высокотехнологич- ных электрических соединителей нового поколения. Увеличение объемов производства соединителей общепромышлен- ного назначения в натуральном выражении до 2000000 штук ** в год

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
226. Техническое перевооружение испытательного центра для обеспечения комплекса работ по корпусированию и испытаниям сложнофункциональных интегральных схем в открытом акционерном обществе "Российский научно-исследовательский институт "Электронстандарт", г. Санкт-Петербург	<u>373,66</u> 186,83					<u>200</u> 100	<u>173,66</u> 86,83	2012 - 2013	1145	увеличение объема производства изделий до 1,9 млн. штук и 650 млн. рублей
227. Реконструкция и техническое перевооружение научно-технического комплекса по разработке и производству высокочастотных и	<u>700</u> 350*						<u>220</u> 110	2013 - 2015	550	увеличение объема выпуска продукции на 2 млрд. рублей**

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
сверхвысоко- частотных акустоэлектронных и пьезокварцевых устройств в откры- том акционерном обществе "Омский научно-исследова- тельский институт приборостроения", г. Омск										
228. Реконструкция и техническое первооружение производственно- технологической и лабораторно- испытательной базы на федеральном государственном унитарном пред- приятии "Научно-исследо- вательский институт "Экран", г. Самара	557,6 403	113,5 110	108,4 88	115,7 95	220 110			2008 - 2011	879	создание конкуренто- способных изделий мирового уровня. Разработка технологий двойного назначения. Увеличение объема производства в 1,5 раза

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
229. Реконструкция и техническое перевооружение производственной технологической и лабораторной базы для комплексов специальной радиосвязи и управления на федеральном государственном унитарном предприятии "Омский научно-исследовательский институт приборостроения", г. Омск	$\frac{694,52}{349,91}^*$			$\frac{15,5}{10,4}$	$\frac{79,2}{39,6}$	$\frac{300}{150}$	$\frac{119,82}{59,91}$	$\frac{90}{45}$	1300	создание комплексов конкурентоспособной аппаратуры специальной радиосвязи и управления. Увеличение объема выпуска продукции в 1,5 раза
230. Техническое перевооружение производства сверхвысокочастотных и силовых транзисторов для бортовых радиолокационных комплексов в открытом	$\frac{280}{140}^*$								$\frac{103,92}{51,96}$	дооснащение действующих производственных участков современным технологическим, высокопроизводительным оборудованием в
									$\frac{176,08}{88,04}$	219***

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
акционерном обществе "Государственный завод "Пульсар", г. Москва										обеспечение производства мощных СВЧ и силовых транзисторов для бортовых радиолокационных комплексов**
231. Техническое первооружение и реконструкция производственно- технологической и лабораторно- испытательной базы по созданию модернизированной системы идентифи- кации на федераль- ном государствен- ном унитарном предприятии "Пензенское производственное объединение электронной вычислительной техники", г. Пенза	$\frac{557,08}{278,54}^*$					$\frac{200}{100}$	$\frac{127,08}{63,54}$	$\frac{115}{57,5}$	$\frac{115}{57,5}$	увеличение объема выпуска продукции до 421,5 млн. рублей**

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реализации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты		
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год				2014 год	2015 год
232. Техническое перевооружение и реконструкция метрологической, испытательной базы и производства оптических изделий на федеральном государственном унитарном предприятии "Нижегородский научно-исследовательский приборостроительный институт "Кварц", г. Нижний Новгород	594,16 297,08*					280 140	74,16 37,08	120 60	120 60	2012 - 2015	1365,3	создание метрологической, испытательной базы для разработки и производства контрольно-измерительной аппаратуры миллиметрового диапазона длин волн. Увеличение объема производства квантовых рубидиевых стандартов частоты в 3 раза
233. Техническое перевооружение и реконструкция стендовой и испытательной базы сложных радио-электронных систем и комплексов в открытом акционерном обществе	100 50					100 50****				2012	362	создание систем навигации посадки и радиолокации потеряло актуальность в связи с созданием в открытом акционерном обществе "Научно-производственное

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
"Производственное объединение "Азимут", г. Махачкала, Республика Дагестан										объединение "Лианозовский электромехани- ческий завод", г. Москва, современных конкурентно- способных комплексов, которые будут оснащены аэродромы России (1 образец установ- лен в г. Сочи)
234. Техническое первооружение производственно- технологической и лабораторно- испытательной базы в открытом акционерном обществе "Научно- исследовательский институт полупроводниковых приборов", г. Томск	$\frac{570}{285}^*$					$\frac{210}{105}$	$\frac{120}{60}$	2012 - 2015	2000	увеличение объема выпуска продукции до 3 - 3,5 млрд. рублей в год

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2015 год			
235. Техническое перевооружение и реконструкция производства сверхвысокочастотной техники на федеральном государственном унитарном предприятии "Научно-производственное предприятие "Салют", г. Нижний Новгород	1014,14 507,07						640 320	374,14 187,07	2012 - 2013	2087,41	увеличение объема производства монолитно-интегральных и гибридно-монолитных приборов и электронных компонентов (в том числе импорт-тозамещающих) до 250 тыс. штук в год, электро-вакуумных и вакуумно-твердотельных модулей (в том числе на основе микроминиатюрных ламп бегущей волны) до 1 тыс. штук в год, унифицированных приемопередающих модулей (в диапазоне частот 20 - 150 ГГц) до 1,5 тыс. штук в год

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
236. Реконструкция и техническое переворужение для выпуска теплоотводящих керамических подложек для твердотельных сверхвысокочастот- ных устройств и IGBT-модулей в открытом акционерном обществе "Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз", г. Новосибирск	$\frac{120}{60}$					$\frac{120}{60}$ ***		2012	2752	расширение производства потеряло актуаль- ность в связи с завершением на федеральном государственном унитарном предприятии "Федеральный научно-производ- ственный центр производственное объединение "Старт" имени М.В.Проценко" технического переворужения производства металлокерами- ческих корпусов микросборок и микросхем, ориентированного на выпуск аналогичной продукции

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
237. Техническое перевооружение и реконструкция опытного приборного производства в открытом акционерном обществе "Концерн "Океанприбор", г. Санкт-Петербург	610,50 305,25*					400 200	90,5 45,25	120 60	2012 - 2014	2032,5	реконструкция опытного производства с учетом реализации новых технологий по изготовлению интегральных сборок, датчиков на пьезопленках и других
238. Реконструкция и техническое перевооружение организации для совершенствования судовой электротехнической продукции в Федеральном научно-производственном центре открытым акционерном обществе "Научно-производственное объединение "Марс",	832 416*					200 100	240 120	196 98	2012 - 2015	2450	комплексное дооснащение базовых технологий производства электронных средств вычислительной техники в целях импортозамещения и повышения конкурентоспособности, создание экспериментально-лабораторного комплекса для проведения

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
г. Ульяновск										
239. Реконструкция и техническое первооружение опытно- экспериментального производства модулей функциональной микроэлектроники в открытом акционерном обществе "Концерн "Гранит-Электрон", г. Санкт-Петербург	$\frac{240}{120}^*$					$\frac{80}{40}$	$\frac{60}{30}$	$\frac{50}{25}$	$\frac{50}{25}$	800
								2012 - 2015		контроля технологи- ческих парамет- ров и испытаний**
										техническое первооружение обеспечит внедрение совре- менных техноло- гий производства модулей функцио- нальной микро- электроники, рост объема производства функциональных модулей в 2 - 2,5 раза, расширение номенклатуры без существенных затрат на подготов- ку производства, промышленное освоение технологий влагозащиты и электроизоляции модулей**

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
240. Создание производственного комплекса для массового производства компонентов инерциальных микромеханических датчиков двойного назначения на открытом акционерном обществе "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электронприбор", г. Санкт-Петербург	$\frac{1100}{550}^*$					$\frac{280}{140}$	$\frac{270}{135}$	$\frac{275}{137,5}$	$\frac{275}{137,5}$	создание участков по производству кремниевых датчиков, многослойных плат, сборке и корпусированию инерциальных микромеханических изделий**
241. Реконструкция инженерно-испытательного корпуса в открытом акционерном обществе "Концерн "Гранит-Электрон", г. Санкт-Петербург	$\frac{620}{310}^*$					$\frac{160}{80}$	$\frac{260}{130}$	$\frac{100}{50}$	$\frac{100}{50}$	внедрение современных базовых технологий производства электронных модулей цифровой и цифроаналоговой вычислительной техники, обеспечение разработки и производ-

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год				2015 год
242. Техническое перевооружение производственно-технологического комплекса по созданию оптико-электронной компонентной базы в открытом акционерном обществе "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики", г. Казань, Республика Татарстан	$\frac{460}{230^*}$					$\frac{80}{40}$	$\frac{70}{35}$	$\frac{155}{77,5}$	$\frac{155}{77,5}$	2012- 2015	3272	создание новой оптической элементной базы перспективных оптико-электронных систем, обеспечивающей предельно возможные технические параметры систем, в том числе комплексированных и много-спектральных оптических каналов**

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реализации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год				2014 год
243. Реконструкция корпуса 2Ж для создания лабораторно-аналитического центра инфракрасной фото- и оптоэлектроники на федеральном государственном унитарном предприятии "Научно-производственное объединение "Орион", г. Москва	700 350*					<u>180</u> 90	<u>160</u> 80	<u>180</u> 90	<u>180</u> 90	2012-2015	создание единого аналитического центра по исследованиям и сертификации важнейших материалов и компонентов инфракрасной фотоэлектроники**
244. Техническое перевооружение производственно-технологического комплекса по созданию оптоэлектронной компонентной базы на федеральном государственном унитарном предприятии	<u>3681</u> 1840,5*					<u>1280</u> 640	<u>261</u> 130,5	<u>930</u> 465	<u>1210</u> 605	2012 - 2015	создание производственно-технологического комплекса, который обеспечит промышленный выпуск изделий компонентной базы 2-го и 3-го поколений и опτικο-электронных систем на их

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты		
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год				2014 год	2015 год
"Научно- производственное объединение "Орион", г. Москва										основе с параметрами, превышающими современный и прогнозируемый ** мировой уровень		
245. Реконструкция и техническое переворужение стендово- экспериментальной базы в открытом акционерном обществе "Научно- исследовательский институт авиационного оборудования", г. Жуковский, Московская область	420 210*					70 35	60 30	145 72,5	145 72,5	2012- 2015	1500	обеспечение возможности проведения испытаний опытных образцов источников электроэнергии, статических преобразователей и аппаратуры защиты и коммутации для проекта "полностью электрический самолет"***
246. Реконструкция и техническое переворужение в целях создания межотраслевого	356 178*							65 0	291 178	2014- 2015	1801,3 ***	создание лабораторной и испытательной базы и производственных

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год		
центра по разра- ботке и производ- ству пассивных электронных компонентов на открытом акционерном обществе "Научно- исследовательский институт развития соединителей и изделий специальной электроники", г. Казань											мощностей по разработке и выпуску перспективных электрических соединителей двойного назначения для радиоэлектронной, авиационной и ракетно- космической отрасли**
247. Реконструкция и техническое первооружение экспериментально- технологической базы для производ- ства микроэлект- ронных изделий в открытом акционерном обществе "Казанское прибо- роостроительное	<u>370,08</u> 185,04*					<u>100</u> 50	<u>54,08</u> 27,04	<u>123</u> 61,5	<u>93</u> 46,5	2012 - 2015	создание производственных мощностей по производству современной микроэлектронной аппаратуры**

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реализации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
конструкторское бюро", г. Казань, Республика Татарстан										
248. Реконструкция и техническое перевооружение цеха по производству первичных преобразователей и вторичной аппаратуры в открытом акционерном обществе "Казанское приборостроительное конструкторское бюро", г. Казань, Республика Татарстан	$\frac{222,12}{111,06^*}$	$\frac{100}{50}$	$\frac{42,12}{21,06}$	$\frac{60}{30}$	$\frac{20}{10}$	2012 - 2015	2040,8	производство конкурентоспособной продукции, обладающей современными показателями по надежности, быстродействию и массогабаритным характеристикам**		
249. Реконструкция и техническое перевооружение производства электронных систем самолетного	$\frac{458}{229^*}$	$\frac{17,389}{0}$	$\frac{440,611}{229}$	2014 - 2015	4860***	серийное производство широкой номенклатуры статических преобразователей				

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
энергоснабжения в открытом акционерном обществе "Уфимское агрегатное производственное объединение", г. Уфа, Республика Башкортостан										напряжения авиационных перспективных объектов (проект "полностью электрический самолет", истребитель 5-го поколения, программа развития гражданской авиационной техники)
250. Реконструкция и техническое переворужение для создания электронного полигона по исследованиям, отработке и сертификации бортового авиационного радиоэлектронного оборудования в открытом	$\frac{1070}{535^*}$							$\frac{350}{175}$	$\frac{720}{360}$	полигон позволит проводить работы с радио- электронной аппаратурой в условиях реального полета с учетом информационного взаимодействия с наземными и самолетными системами обеспечения

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год		
акционерном обществе "Летно- исследовательский институт имени М.М.Громова", г. Жуковский, Московская область											воздушного движения в реальных условиях естественных и промышленных помех**
251. Техническое переворужение в целях создания производственного участка на стройки быстродействую- ющих бортовых цифровых устройств с тактовой частотой более 500 МГц в открытом акционерном обществе "Ставропольский радиозавод "Сигнал", г. Ставрополь	300 150*						100 50	100 50	100 50	1300	создание производственного участка на стройки быстро- действующих бортовых цифровых устройств с тактовой частотой более 500 МГц**

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
252. Техническое перевооружение в целях создания лабораторно-испытательной базы для изготовления и испытаний сверхширокополосных сверхвысоко-частотных устройств сантиметрового диапазона с перекрытием по частоте более 3 октав в открытом акционерном обществе "Ставропольский радиозавод "Сигнал", г. Ставрополь	$\frac{380}{190}^*$						$\frac{150}{75}$	$\frac{115}{57,5}$	$\frac{115}{57,5}$	создание лабораторно-испытательной базы для изготовления и испытаний сверхширокополосных сверхвысоко-частотных устройств сантиметрового диапазона с перекрытием по частоте более 3 октав**
253. Реконструкция и техническое перевооружение производства специализированных цифровых	$\frac{995,40}{497,7}^*$						$\frac{620}{310}$	$\frac{257,9}{187,7}$	$\frac{117,5}{0}$	освоение технологий производства перспективных многопроцессорных специализиро-

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
вычислительных машин в открытом акционерном обществе "Государственный Рязанский приборный завод", г. Рязань											ванных цифровых вычислительных машин, построенных на основе архитек- туры единой коммутируемой вычислительной среды, с использованием принципов интегральной модульной авионики второго поколения, ориентированных на обеспечение принципиально нового уровня надежности и универсальности комплекса аппара- туры авионики**
254. Техническое первооружение участка микроэлектроники в открытом	320 160						140 70	90 45	2013 - 2015	588	увеличение объемов производства сверхвысоко- частотной

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
акционерном обществе "Научно- производственное предприятие "Радиосвязь", г. Красноярск										электронной компонентной базы на основе перспективных технологий низко- температурной керамики
255. Техническое переворужение для создания производства изделий микро- и наноэлектроники на федеральном государственном унитарном предприятии "Научно- исследовательский институт физичес- ких проблем им. Ф.В.Лукина", г. Москва	<u>867,476</u> 433,738							2014 – 2015	440 ^{***}	создание кластерного сверхвысоко- вакуумного технологического комплекса на основе беспалон- ного многолуче- вого электронного литографа для пластин диаметром до 200 мм для организации серийного производства гироскопов
256. Техническое переворужение федерального государственного	<u>100</u> 50							2014 2015	925,1 ^{***}	создание проектно- конструкторского центра по проектированию

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
унитарного предприятия "Научно- производственное предприятие "Гамма", г. Москва										цифровых и аналоговых микросхем и микроволновых и сверхвысоко- частотных устройств, элементов вычислительной техники и специальной радиоэлектронной аппаратуры для решения задач информационной безопасности с участком контрактного производства
257. Техническое переворужение научной, производственной и лабораторно- испытательной базы на федеральном государственном унитарном	<u>158</u> 79							2014 - 2015	990***	создание много- функционального информационно аналитического центра, обеспечивающего возможность моделирования испытаний

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
предприятия "Московское конструкторское бюро "Электрон", г. Москва										сложных информационно управляющих процессов, а также расширения и технического переворужения производственной площадки предприятия в целях увеличения номенклатуры и глубины анализа радиоэлектронного авиационного оборудования
258. Техническое переворужение федерального государственного унитарного предприятия "Научно- производственное предприятие "Пульсар", г. Москва, для создания базового	$\frac{100}{50}$				$\frac{100}{50}$				135,1	создание межотраслевого базового центра системного проектирования

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
центра системного проектирования										
259. Реконструкция и техническое перевооружение открытого акционерного общества "Информационные телекоммуникационные технологии", г. Санкт-Петербург, для создания базового центра полного цикла проектирования и производства аппаратно-программных комплексов	<u>119,873</u> 60	<u>119,873</u> 60						2008	1911	создание базового центра системного проектирования производственнойностью 40 аппаратно-программных комплексов в год
260. Техническое перевооружение для создания базового центра системного проектирования микроэлектронных модулей нового	<u>120</u> 60	<u>120</u> 60						2011	1324	обеспечение проектирования, производства, испытаний, контроля, тестирования и сертификации

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
поколения на основе технологии "систем в модуле" двойного и специального применения на открытом акционерном обществе "Научно- исследовательский институт "Вектор", г. Санкт-Петербург										перспективных изделий, включая климатические, механические, надежные и другие специа- лизированные испытания, а также сертификации выпускаемых изделий по требованиям различных категорий заказчиков и производств
261. Техническое перевооружение открытого акцио- нерного общества "Всероссийский научно-исследова- тельский институт радиотехники", г. Москва, для создания базового центра проектирования	<u>50</u> 25				<u>50</u> 25			2011	422,8	создание базового центра системного проектирования

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
262. Техническое перевооружение открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт молекулярной электроники и завод "Микрон", г. Москва, для создания базового центра проектирования	<u>540</u> 270			<u>80</u> 40	<u>460</u> 230			2010 - 2011	151,3	создание базового центра системного проектирования
263. Реконструкция и техническое перевооружение федерального государственного унитарного предприятия "Научно-исследовательский институт авионики", г. Москва, для создания базового центра проектирования	<u>35,37</u> 30		<u>35,37</u> 30					2009	493	создание базового центра системного проектирования

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
264. Техническое перевооружение федерального государственного унитарного предприятия "Научно-производственное предприятие "Восток", г. Новосибирск, для создания базового центра проектирования	$\frac{140}{70}$				$\frac{140}{70}$			2011	599,85	создание базового центра системного проектирования
265. Техническое перевооружение открытого акционерного общества "Концерн "Созвездие", г. Воронеж, для создания базового центра проектирования	$\frac{182,3}{100}$			$\frac{62,3}{40}$	$\frac{120}{60}$			2010 - 2011	700	создание базового центра системного проектирования
266. Техническое перевооружение открытого акционерного	$\frac{130}{100}$			$\frac{130}{100}$				2010	998	создание базового центра системного проектирования площадью

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
общества "Концерн радиостроения "Вега", г. Москва, для создания базового центра проектирования										998 кв. метров
267. Реконструкция и техническое первооружение федерального государственного унитарного предприятия "Ростовский-на- Дону научно- исследовательский институт радиосвязи", г. Ростов-на-Дону, для создания базового центра проектирования	$\frac{120,6}{60}$			$\frac{120,6}{60}$				2010	500	создание базового центра системного проектирования площадью 500 кв. метров
268. Реконструкция и техническое первооружение действующего предприятия	$\frac{17}{17}$	$\frac{17}{17}$						2008	500	создание базового центра системного проектирования площадью 500 кв. метров

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
федеральное государственное унитарное предприятие "Омский научно- исследовательский институт приборо- строения", г. Омск (развитие базового центра системного проектирования сверхбольших интегральных схем)										
269. Техническое первооружение открытого акцио- нерного общества "Российский институт радионавигации и времени", г. Санкт- Петербург, для создания базового центра проектирования	$\frac{120}{60}$				$\frac{120}{60}$			2011	490	создание базового центра системного проектирования площадью 490 кв. метров

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
270. Реконструкция и техническое перевооружение открытого акцио- нерного общества "Центральный научно-исследо- вательский инсти- тут "Циклон", г. Москва, для создания базового центра проекти- рования	$\frac{80}{80}$ ****			$\frac{80}{80}$ ****				2010	800	создание базового центра системного проектирования площадью 800 кв. метров
271. Техническое перевооружение федерального государственного унитарного предприятия "Государственный завод "Пульсар", г. Москва, для создания базового центра проектирования	$\frac{200}{100}$				$\frac{200}{100}$			2011	648	создание базового центра системного проектирования площадью 648 кв. метров мощностью 360 тыс. штук

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
272. Реконструкция и техническое первооружение федерального государственного унитарного пред- приятия "Научно- исследовательский институт "Аргон", г. Москва, для создания базового центра проектирования	$\frac{68,9}{60}$	$\frac{68,9}{60}$							2008	532	создание базового центра системного проектирования
273. Реконструкция и техническое первооружение открытого акционерного общества " "Научно- производственное объединение "Орион", г. Москва, для создания базового центра проектирования	$\frac{33,53}{15^*}$	$\frac{15}{7,5}$	$\frac{18,53}{7,5}$						2014 - 2015	500	создание базового центра системного проектирования площадью 500 кв. метров**

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
274. Реконструкция и техническое переворужение федерального государственного унитарного предприятия "Новосибирский завод полупровод- никовых приборов с ОКБ", г. Новоси- бирск, для создания базового центра проектирования	$\frac{83,62}{60}$	$\frac{83,62}{60}$	$\frac{83,62}{60}$						2009	500 создание базового центра системного проектирования площадью 500 кв. метров
275. Реконструкция и техническое переворужение федерального государственного унитарного пред- приятия "Научно- исследовательский институт телевидения", г. Санкт-Петербург, для создания базового центра проектирования	$\frac{101,54}{80}$	$\frac{101,54}{80}$	$\frac{101,54}{80}$						2008	600 создание базового центра системного проектирования площадью 600 кв. метров

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
276. Техническое перевооружение открытого акционерного общества "Концерн "Океанприбор", г. Санкт-Петербург, для создания базового центра проектирования	$\frac{140}{70}$							2011	600	создание базового центра системного проектирования площадью 600 кв. метров
					$\frac{140}{70}$					
277. Реконструкция и техническое перевооружение федерального государственного унитарного предприятия "Нижегородский научно-исследовательский приборостроительный институт "Кварц", г. Нижний Новгород, для создания базового центра проектирования	$\frac{75,4}{72,7}$	$\frac{75,4}{72,7}$						2008	1097,8	создание базового центра системного проектирования

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
278. Техническое перевооружение и реконструкция открытого акционерного общества "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", г. Королев, Московская область, для создания базового центра системного проектирования	$\frac{104}{80}$	$\frac{104}{80}$						2008	650	создание базового центра системного проектирования площадью 650 кв. метров
279. Техническое перевооружение федерального государственного унитарного предприятия "Научно-исследовательский институт "Экран", г. Самара, для создания базового центра проектирования	$\frac{240}{120}$	$\frac{240}{120}$						2011	1134,5	создание базового центра системного проектирования площадью 1134,5 кв. метров мощностью 2000 штук

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
280. Открытое акционерное общество "Государственный оптический институт имени С.И.Вави- лова", г. Санкт- Петербург										
Создание базового центра проектиро- вания на базе федерального государственного унитарного пред- приятия "Научно- производственная корпорация "Государственный оптический институт имени С.И.Вавилова", г. Санкт-Петербург	$\frac{500}{250}^*$	$\frac{290}{145}$	$\frac{160}{80}$			$\frac{50}{25}$	2000	2012 - 2014		создание базового центра по проектированию, моделированию, изготовлению, тестированию и сертификации перспективных оптических систем и оптико- электронного оборудования
281. Реконструкция и техническое первооружение открытого акционерного	$\frac{2200}{1100}^*$	$\frac{590}{295}$	$\frac{520}{260}$			$\frac{545}{272,5}$	6800	2012- 2015		повышение качества и надежности систем цифровой обработки, систем

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год		
общества "Концерн ПВО "Алмаз- Антей", г. Москва, для создания базового центра проектирования систем цифровой обработки, твердотельных передающих и приемных систем, приемо- передающих модулей											твердотельных передающих и приемных систем, приемо-передаю- щих модулей активных фазиро- ванных системных решеток С-диапазона для перспективных средств связи, управления воздушным движением и формирования сигналов на кристалле для радиолокационных станций различного ** применения
282. Реконструкция и техническое переворужение для создания базового центра проектирования в открытом	$\frac{500}{250}^*$					<u>192,38</u> 96,19	<u>120</u> 60	<u>93,81</u> 46,905	<u>93,81</u> 46,905	865,5	создание базового центра проектиро- вания сложных функциональных блоков и сверхбольших интегральных схем

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
акционерном обществе "Концерн "Созвездие", г. Воронеж										"система на кристалле" для нового поколения аппаратуры и мобильных телекоммуника- ционных систем, создание конку- рентоспособных изделий для нового поколения мобиль- ных телеком- муникационных систем гражданского и двойного ** назначения
283. Техническое перевооружение для создания базового центра системного проектирования (дизайн-центра) радиоэлектронных модулей и узлов стационарных и мобильных средств автоматизации в	<u>440</u> 220				<u>440</u> 220			2011	1852	обеспечение производства комплексных средств автоматизации для управления автомобильным и железнодорожным транспортom, объектами топливно-

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
открытом акционерном обществе "Научно- производственное предприятие "Рубин", г. Пенза										энергетического комплекса
284. Создание базового центра системного проектирования унифицированных электронных модулей на основе современной электронной компонентной базы в открытом акционерном обществе "Челябинский радиозавод "Полет", г. Челябинск	<u>200</u> 100			<u>90</u> 45	<u>110</u> 55			2010 - 2011	790	обеспечение возможности изготовления разработанных электронных модулей по современным технологиям, повышение надежности и качества и ускорение разработки конкуренто- способных изделий мирового уровня, разработка техно- логий двойного назначения

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
285. Создание базового центра системного проектирования унифицированных электронных модулей на основе современной электронной компонентной базы в открытом акционерном обществе "Рыбинский завод приборостроения", г. Рыбинск, Ярославская область	$\frac{119,7}{100}$			$\frac{119,7}{100}$					2010	750 обеспечение возможности изготовления разработанных электронных модулей по современным технологиям, разработка технологий двойного назначения мощностью 5 модулей в год
286. Техническое перевооружение для создания базового центра системного проектирования микроэлектронных модулей нового поколения на основе технологии "система в модуле" двойного и специального	$\frac{180}{90}$				$\frac{180}{90}$				2011	640 обеспечение проектирования, производства, испытаний, контроля, тестирования и сертификации перспективных изделий, включая климатические, механические, надежность и

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год		
применения в открытом акцио- нерном обществе "Калужский научно- исследовательский институт телемеханических устройств", г. Калуга											другие специали- зованные испытания, а также сертификации выпускаемых изделий по требо- ваниям различных категорий заказчиков и производств
287. Создание базового центра системного проектирования микроэлектронных модулей нового поколения на основе технологии "система в модуле" двойного и специального применения в открытом акцио- нерном обществе "Московский научно- исследовательский институт связи", г. Москва	30 30****			30 30****					2010	260	обеспечение проектирования, производства, испытаний, контроля, тестирования и сертификации перспективных изделий, включая климатические, механические, надежностные и другие специали- зованные испытания, а также сертификации выпускаемых изделий по

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
288. Расширение базового центра системного проектирования по проектированию радиоэлектронной аппаратуры на базе сверхбольших интегральных схем "система на кристалле" в открытом акционерном обществе "Концерн радиостроения "Вега", г. Москва	<u>317,56</u> 158,78*					<u>141,4</u> 70,7	<u>100</u> 50	<u>76,16</u> 38,08	2012- 2014	расширение возможностей и объемов базового центра системного проектирования за счет использования передовых технологий разработки радио-электронных изделий. Ускорение процесса получения готовых проектов не менее чем в 2 раза**
289. Техническое перевооружение для создания базового центра системного проектирования высокоплотных	<u>210</u> 105				<u>210</u> 105				2011	обеспечение проектирования, производства высокоплотных электронных узлов на основе

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
электронных узлов на основе технологии многокристалльных модулей в открытом акционерном обществе "Научно- исследовательский институт "Кулон", г. Москва										технологии многокристалльных модулей как ключевой техноло- гии достижения высоких технических характеристик разрабатываемых и производимых изделий. Планируемый объем выпуска многокристалльных модулей до 3,5 тыс. штук в год
290. Создание базового центра системного проектирования высокоплотных электронных узлов на основе технологии многокристалльных модулей в открытом акционерном обществе "Конструкторское	<u>165,6</u> 105			<u>45,6</u> 45	<u>120</u> 60			2010 - 2011	350	обеспечение проектирования, производства высокоплотных электронных узлов на основе технологии много- кристалльных модулей как ключевой техноло- гии достижения высоких

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
бюро "Луч", г. Рыбинск, Ярославская область										технических характеристик разрабатываемых и производимых изделий. Планируемый объем выпуска многокристалльных модулей до 3,5 тыс. штук
291. Техническое перевооружение для обеспечения интеграции базовых центров системного проектирования в сквозную корпора- тивную систему разработки радиоэлектронных комплексов в открытом акционерном обществе "Концерн радиостроения "Вега", г. Москва	$\frac{500}{250}^*$							2014- 2015	4580 ^{***}	создание базового центра проектирования и расширение возможностей и объемов разрабатываемой номенклатуры изделий за счет тесной интеграции разнодисциплинар- ных базовых центров системного проектирования радиоэлектронных изделий, существенное

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	

снижение времени и себестоимости комплексных разработок высокопроизводительных сверхбольших интегральных схем, микропроцессорной техники, матричных корпусов, в том числе для сверхбольших интегральных схем с большим количеством выводов, контроллеров перспективных периферийных интерфейсов для разработки на их базе перспективных сложнофункциональных блоков, радиоэлектронной аппаратуры, универсальных цифровых устройств, комплексов, систем и

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
292. Техническое перевооружение для создания базового центра проектирования универсальных микропроцессоров, систем на кристалле, цифровых приборов обработки сигналов и других цифровых устройств, комплексов и систем на базе современных лицензионных систем автоматизированного проектирования и технических средств открытого акционерного общества "Институт электронных	450 <u>265*</u>			80 <u>80****</u>	90 <u>45</u>		140 <u>70</u>	140 <u>70</u>	2010- 2014	1530
										создание базового центра разработки высокопроизводительной микропроцессорной техники двойного назначения, оснащенной современной технологией разработки многоядерных систем на кристалле, матричных корпусов для сверхбольших интегральных схем с большим количеством выводов, контроллеров перспективных периферийных интерфейсов для разработки на их

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реализации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
управляющих машин" им. И.С.Брука, г. Москва										базе высокопроизводительных вычислительных систем широкого применения
293. Техническое перевооружение и реконструкция базового регионального научно-технологического центра по микро-системотехнике открытого акционерного общества "Омский научно-исследовательский институт приборостроения", г. Омск	811,58 405,79*					280 140	439,62 219,81	91,96 45,98	2012 - 2014	ускорение проектирования и отработки технологий производства перспективных устройств микро-системотехники для комплектования аппаратуры управления, средств телекоммуникации и связи, высокоточного оружия, робототехнических комплексов, мониторинга окружающей среды, зданий и сооружений, систем трубопроводов, водо- и газоснабжения,

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
294. Реконструкция и техническое первооружение центра системного проектирования и производства радиоэлектронных средств спутнико- вой связи открытого акционерного общества "Научно- производственный центр "Вигстар", г. Москва	$\frac{490}{245^*}$					$\frac{120}{60}$	$\frac{160}{80}$	$\frac{105}{52,5}$	$\frac{105}{52,5}$	1701,8 создание конкуренто- способных изделий мирового уровня двойного назначения для комплексов аппаратуры спутниковой связи**

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
295. Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Алмаз", г. Саратов										
Реконструкция и техническое перевооружение на федеральном государственном унитарном предприятии "Научно-производственное предприятие "Алмаз", г. Саратов, в целях создания дизайн-центра и производства сверхвысоко-частотных и силовых устройств	<u>1000,12</u> 500,06					670	<u>330,12</u> 165,06	2012 - 2013	3221,35	создание дизайн-центра площадью 3221,35 кв. метра и увеличение выпуска продукции на 500 млн. рублей в год
296. Техническое перевооружение для создания центра проектирования	<u>89,1</u> 45	<u>89,1</u> 45						2008	189	создание конкуренто-способной технологии

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	

перспективной
электронной
компонентной базы
на федеральном
государственном
унитарном
предприятии
"Научно-
исследовательский
институт
электронной
техники",
г. Воронеж

автоматизиро-
ванного
проектирования
кристаллов
сверхбольших
интегральных схем
и систем на
кристалле с
проектными
нормами
0,18 - 0,13 мкм и
степенную
интеграции до
100 млн. вентиля
на кристалле, что
позволит обеспе-
чить ускоренную
разработку слож-
нофункциональных
блоков, сверхболь-
ших интегральных
схем и систем на
кристалле,
соответствующих
по техническим
характеристикам
современным
мировым образцам

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
297. Создание отраслевого центра системного уровня проектирования интеллектуальных датчиков различ- ного назначения на открытом акционерном обществе "Концерн "Центральный научно- исследовательский институт "Электроприбор", г. Санкт-Петербург	$\frac{340}{170}^*$					$\frac{90}{45}$	$\frac{174}{87}$	$\frac{38}{19}$ 2012 - $\frac{38}{19}$ 2015	303	организация современного центра системного уровня проектиро- вания на основе отечественной электронной компонентной базы: микромеханичес- ких датчиков; датчиков акусти- ческого давления; датчиков угловых перемещений и других**
298. Создание отраслевого центра проектирования сложных функциональных блоков и сверхболь- ших интегральных схем "система на кристалле" на открытом акционерном обществе "Концерн	$\frac{360}{180}^*$					$\frac{90}{45}$	$\frac{135}{67,5}$	$\frac{135}{67,5}$ 2012 - $\frac{135}{67,5}$ 2015	609	создание отраслевого центра проектирования (дизайн-центра) сложных функцио- нальных блоков и сверхбольших интегральных схем "система на кристалле" для обеспечения новой цифровой

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
"Моринформ- система-Агат", г. Москва										вой техникой при- боростроительных организаций судостроительной отрасли**
299. Техническое первооружение базового центра проектирования и производства специальных многокристалльных микросистем и микромодулей с использованием технологии 3D TSV в открытом акцио- нерном обществе "Российская электроника", г. Москва	$\frac{300}{150}^*$						$\frac{200}{100}$	$\frac{100}{50}$	2013 - 2014	создание базового центра проектиро- вания площадью 600 кв. метров**
300. Реконструкция и техническое первооружение для создания базового центра проектирования составных частей,	$\frac{844}{422}$						$\frac{140}{0}$	$\frac{704}{422}$	2014 - 2015	создание базового центра проектиро- вания площадью 6000 кв. метров***

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
компонентов и приемо-передаю- щих модулей радиолокационных систем с антенно- фидерными решетками в открытом акционерном обществе "Корпора- ция "Фазотрон - Научно-исследова- тельский институт радиостроения", г. Москва										
301. Реконструкция и техническое первооружение открытого акцио- нерного общества "Российская электроника", г. Москва (включая приобретение программно- технических средств), в целях создания	<u>724,95</u> 590,75	<u>156</u> 78	<u>404,55</u> 352,75	<u>164,4</u> 160				2008 - 2010	375,5	создание межотраслевого центра проектирования, каталогизации и изготовления фотошаблонов с объемом производства не менее 1200 штук в год

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			

межотраслевого
центра
проектирования,
каталогизации и
изготовления
фотошаблонов

Всего по
Минпромторгу
России

68917,221 1618,713 1643,438 2125,3 5740 18466,52 14702,44 12039,685 12584,655
36140,295 1267,7 1412,71 1695 2870 9233,26 7351,22 6049,648 6260,757

2. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"

302. Техническое перевооружение федерального государственного унитарного предприятия Федерального научного производственного центра "Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е.Седакова", г. Нижний Новгород	<u>196</u> 98	<u>40</u> 20	<u>48</u> 24	<u>48</u> 24	<u>60</u> 30	2010 - 2013	267	создание технологического комплекса для производства сверхвысоко-частотных монолитных интегральных схем на широкозонных полупроводниковых материалах
---	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----	--

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
303. Техническое переворужение производства сильноточных электронных коммутирующих элементов на федеральном государственном унитарном предприятии "Всероссийский научно-иссле- довательский институт автоматики им. Н.Л.Духова", г. Москва	$\frac{160}{80}^*$						$\frac{60}{30}$	2013 - 2015	616,7	техническое переворужение производств сильноточных электронных коммутирующих элементов
304. Техническое переворужение для организации высо- котехнологичного производства металлокерамичес- ких корпусов микросборок и микросхем на федеральном государственном	$\frac{214}{107}^*$						$\frac{102}{51}$	2013 - 2015	850	техническое переворужение производства металлокера- мических корпусов микросборок и микросхем

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	

унитарном предпри-
ятии федеральном
научно-производст-
венном центре
"Производственное
объединение
"Старт" имени
М.В.Проценко",
г. Заречный,
Пензенская область

305. Техническое переворужение участков производ- ства коммунитирую- щих элементов нового поколения с лазерным поджигом на федеральном государственном унитарном предпри- ятии "Всероссий- ский научно- исследовательский институт автоматики им. Н.Л.Духова", г. Москва	<u>130</u> 65*	<u>50</u> 25	<u>80</u> 40	2014- 2015	509,3***	техническое переворужение участков производства коммунитирующих элементов нового поколения с лазерным поджигом**
--	-------------------	-----------------	-----------------	---------------	----------	--

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
306. Техническое перевооружение в целях производства радиационно стойких изделий микроэлектроники с применением методов нанотехнологий на федеральном государственном унитарном предприятии "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л.Духова", г. Москва	$\frac{400}{200}^*$					$\frac{100}{50}$	$\frac{100}{50}$	2012 - 2015	2148,1	создание производственно-технологического участка изготовления изделий микро-электроники для систем автоматики** специзделий
307. Техническое перевооружение в целях производства быстросействующих радиационно стойких монолитных интегральных схем на федеральном государственном унитарном	$\frac{350}{175}^*$						$\frac{134}{67}$	2013 - 2015	2500	создание производственно-технологического участка в межведомственном центре по разработке и производству радиационно стойкой

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
предприятия Федеральный научно-производ- ственный центр "Научно-исследова- тельский институт измерительных систем им. Ю.Е.Седакова", г. Нижний Новгород										электронной компонентной базы**
308. Техническое перевооружение в целях производства радиационно стойких изделий микросистемотех- ники на федеральном государственном унитарном предпри- ятии Федеральный научно- производственный центр "Научно- исследовательский институт измерительных	$\frac{536}{268}^*$						$\frac{204}{102}$	$\frac{158}{79}$	$\frac{174}{87}$	2013 - 2015 создание производственно- технологического участка в межведомственном центре по разработке и производству радиационно стойкой электронной компонентной базы**

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
систем им. Ю.Е.Седакова", г. Нижний Новгород										
309. Техническое первооружение в целях производства радиационно стойких изделий микроэлектроники на федеральном государственном унитарном предприятии "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследова- тельский институт экспериментальной физики", г. Саров, Нижегородская область	$\frac{1720}{860^*}$					$\frac{232}{116}$	$\frac{240}{120}$	$\frac{724}{362}$	$\frac{524}{262}$	2012- 2015 техническое первооружение технологических участков предприятия по изготовлению радиационно стойких изделий микроэлектроники обеспечит создание чистых помещений с высоко- технологичным оборудованием, что позволит внедрить в производство более 120 новых технологических процессов по изготовлению принципиально новых радиацион- но стойких

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
310. Реконструкция дизайн-центра радиационно стойкой электронной компонентной базы на федеральном государственном унитарном пред- приятии Федераль- ный научно- производственный центр "Научно- исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е.Седакова", г. Нижний Новгород	<u>200</u> 100	<u>80</u> 40	<u>68</u> 34		<u>52</u> 26			2008 - 2011	2976	высоко- функциональных изделий микроэлектроники и микросистем для приборов ** автоматики реконструкция дизайн-центра мощностью 1 млн. транзисторов в год

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
311. Техническое первооружение дизайн-центра радиационно стойкой электрон- ной компонентной базы на федераль- ном государствен- ном унитарном предприятии "Всероссийский научно-исследова- тельский институт автоматики им. Н.Л.Духова", г. Москва	240 120*					100 50	120 60	20 10	2012 - 2014	506	техническое первооружение дизайн-центра радиационно стойкой электронной компонентной базы позволит обеспечить разработку и автоматизи- рованную верификацию специальных прототипов разрабатываемых сверхбольших интегральных схем объемом до нескольких десятков тысяч логических элементов, а также верификацию в составе аппара- туры разработан- ных сверхбольших интегральных схем объемом от

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реализации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты	
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год				2014 год
312. Техническое перевооружение дизайн-центра радиационно стойкой электронной компонентной базы на федеральном государственном унитарном предприятии "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики", г. Саров, Нижегородская область	$\frac{120}{60}^*$					$\frac{20}{10}$	$\frac{80}{40}$	$\frac{20}{10}$	2012 - 2014	330	техническое перевооружение дизайн-центра позволит создать высокотехнологичный кластер по разработке принципиально новых радиационно стойких электронных схем и сверхбольших интегральных схем на основе современных базовых матричных кристаллов, их аналого-цифровых преобразователей, перестраиваемых микросхем и запоминающих

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	

устройств большой емкости, что позволит выполнять до 500 логических проектов в год: радиационно стойких сверхбольших интегральных схем на основе полупроводниковых микросхем; сложно-функциональных блоков для сверхбольших интегральных схем "система на кристалле"; микросхем для КМОП и КМОП-КНД-технологий**

313. Техническое перевооружение дизайн-центра радиационно стойкой

180
90*

40
20

40
20

40
20

60
30

2012 -
2015

877,32

техническое перевооружение дизайн-центра позволит создать сквозную систему

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год		

электронной
компонентной базы
на федеральном
государственном
унитарном
предприятии
"Российский
Федеральный
Ядерный Центр -
Всероссийский
научно-исследова-
тельский институт
технической физики
имени академика
Е.И. Забахина",
г. Снежинск,
Челябинская
область

автоматизирован-
ного проектирова-
ния модулей
"система в
корпусе" (SIP-
модулей) с
сокращением на
30 процентов
продолжи-
тельности цикла
разработки,
испытаний и
изготовления SIP-
модулей, расши-
рить номенклатуру
разрабатываемых
приборов с исполь-
зованием указан-
ной технологии до
12 наименований и
моделировать
тепловые и
механические
процессы,
происходящие в
SIP-модулях, с
учетом внешних
воздействующих
факторов**

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
Всего по Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"	4446 2223	80 40	68 34	40 20	100 50	540 270	1140 570	1360 680	1118 559	
3. Роскосмос										
314. Реконструкция и техническое первооружение открытого акцио- нерного общества "Российская корпорация ракетно-космичес- кого приборострое- ния и информа- ционных систем", г. Москва, в целях создания производства многокристалльных систем в корпусе микро- и радиоэлектронных модулей, в том числе на основе устройств микросистемной техники	320 160*						110 55	105 52,5	105 52,5	2013 - 2015 переедшенное производство многокристалльных систем в корпусе микро- и радио- электронных модулей, в том числе на основе устройств микро- системной техники; оснащенное отрас- левое автоматизи- рованное храни- лище производи- мых и приобретаемых электронных компонентов со встроенной систе- мой мониторинга и прогнозирования состояния

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
315. Реконструкция и техническое первооружение открытого акционерного общества "Научно- исследовательский институт точных приборов", г. Москва, для создания производ- ства модулей сверхвысоко- частотных устройств для особо жестких условий эксплуатации	$\frac{320}{160}^*$						$\frac{200}{100}$	$\frac{60}{30}$	2013 - 2015	1313,2	хранимой ** продукции переоснащение производства по выпуску параметрического ряда модулей сверхвысоко- частотных устройств, узлов и крупно- блочных радио- электронных функциональных модулей приемо- передающей аппаратуры. Реализация указан- ных мероприятий обеспечивает сокращение сроков изготовления изделий радио- локационной техники и техники связи в 2 - 3 раза, расширение номенклатуры

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
316. Реконструкция и техническое первооружение открытого акционерного общества "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф.Решетнёва", г. Железнодорожск, Красноярский край, в целях создания производственной линии для изготовления облегченных сверхвысокочас- тотных волноводов миллиметрового диапазона	<u>160</u> 80*						<u>60</u> 30	2013 - 2015	1389,9	сверхвысоко- частотных изделий в 1,5 раза переоснащение производственной линии для выпуска облегченных сверхвысоко- частотных волноводов, увеличение производства сверхвысокочас- тотных волноводов с низким уровнем потерь и улучшен- ными массовыми характеристиками, оснащение отрас- левого автоматизи- рованного храни- лища для модулей радиоэлектронных и навигационных систем со встроен- ной системой мониторинга и прогнозирования

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реализации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты		
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год					
317. Реконструкция и техническое перевооружение федерального государственного унитарного предприятия "Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А.Семихатова", г. Екатеринбург, для создания производства электромеханических и радиоэлектронных компонентов микромодульных средств автономного управления и контроля	$\frac{200}{100}^*$						$\frac{80}{40}$	$\frac{60}{30}$	$\frac{60}{30}$	2013 - 2015	665	дооснащение производства электро-механических и радиоэлектронных компонентов для микромодульных средств автономного управления и контроля, увеличение производства изделий бортовой и промышленной радиоэлектроники на 35 процентов и более, оснащение отраслевого автоматизированного хранилища для радиоэлектронных модулей со встроенной

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
318. Техническое перевооружение открытого акционерного общества "Объединенная ракетно-космическая корпорация", г. Москва, для создания отраслевой лаборатории контроля стойкости электронной компонентной базы для специальной радиоэлектронной аппаратуры в условиях космического пространства, что обеспечит внедрение технологических процессов прямого (в том числе неразрушающего) контроля стойкости электронной компонентной	<u>200</u> 100*						<u>80</u> 40	<u>60</u> 30	2013 - 2015	690	системой мониторинга и прогнозирования состояния хранимой ** продукции создание межотраслевой лаборатории контроля стойкости электронной компонентной базы для специальной радиоэлектронной аппаратуры в условиях космического пространства, что обеспечит внедрение технологических процессов прямого (в том числе неразрушающего) контроля стойкости электронной компонентной

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
319. Реконструкция и техническое переворужение открытого акционерного общества "Научно- производственный	$\frac{200}{100}^*$									базы и эксперимен- тально-аналитичес- кого прогноза деградации характеристик электронной компонентной базы и радио- электронной аппаратуры, определение характеристик стойкости к условиям открыто- го космического пространства, увеличение сроков активного функционирования аппаратуры до 20 лет
										переворужение производственных линий для изготов- ления встроенных модульных пассивных радио- элементов для
							$\frac{80}{40}$	$\frac{60}{30}$	$\frac{60}{30}$	2013 - 2015 2534,3

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год		
центр "Полус", г. Томск, для технического первооружения действующего производства											систем бортовой и промышленной радиоэлектроники и вторичных источников пита- ния с смещен- ными линиями передачи данных и электропитания, расширение номенклатуры и увеличение произ- водства встроен- ных вторичных источников питания с совмещенными линиями передачи данных и электро- питания для средств бортовой и промышленной электроники на 70 процентов и более
320. Реконструкция и техническое первооружение	<u>726</u> 363					<u>486</u> 243	<u>240</u> 120			500	создание базового центра системного проектирования

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
открытого акционерного общества "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем", г. Москва, для создания базового центра проектирования										площадью 500 кв. метров
321. Реконструкция и техническое перевооружение для создания отраслевого центра автоматизированного проектирования в открытом акционерном обществе "Научно-исследовательский институт точных приборов", г. Москва	<u>914</u> 461	<u>120</u> 60	<u>120</u> 60	<u>28</u> 18	<u>160</u> 80	<u>486</u> 243		2008 - 2012	500	создание отраслевого центра автоматизирован- ного проектирова- ния и функцио- нальной поддерж- ки процессов изготовления и эксплуатации параметрических рядов сверхвы- сокочастотных модулей унифи- цированных сверхвысоко- частотных трактов, базовых несущих

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
322. Реконструкция и техническое переворужение для создания центра проектирования унифицированных микроэлектронных датчиков для работы в особо жестких условиях эксплуатации в открытом акционерном обществе "Научно- исследовательский институт физических измерений", г. Пенза	$\frac{280}{140^*}$						$\frac{100}{50}$	2013 - 2015	701	создание центра проектирования унифицированных микроэлектронных датчиков площадью 701 кв. метр для проектирования унифицированных полупроводнико- вых микродат- чиков и преобра- зователей физических величин в системах управления, конт- роля и диагностики динамических объектов**

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год			
323. Реконструкция и техническое первооружение для создания центра проектирования матричных преобразователей и микроэлектронных сигнальных процессоров на федеральном государственном унитарном предприятии "Научно- производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А.Пилогина", г. Москва	$\frac{200}{100}^*$						$\frac{160}{80}$	$\frac{40}{20}$	2013 - 2014	220	создание центра системного проектирования матричных преобразователей и микроэлектронных сигнальных процессоров высокоточных навигационных приборов бортового и промышленного назначения с использованием прецизионного высокотехнологич- ного оборудования для повышения качества проекти- рования, изготовления и надежности аппаратуры систем управления, умень- шения габаритно- массовых характеристик изделий,

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
324. Реконструкция и техническое первооружение для создания базового центра системного проектирования и технического первооружения действующего производства в открытом акцио- нерном обществе "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф.Решетнёва", г. Железнодорожск, Красноярский край	$\frac{148}{74^*}$						$\frac{80}{40}$	2013 - 2015	603,2	сокращение стоимости аппаратуры и др. **
Всего по Роскосмосу	$\frac{3668}{1838}$	$\frac{120}{60}$	$\frac{120}{60}$	$\frac{28}{18}$	$\frac{160}{80}$	$\frac{972}{486}$	$\frac{1190}{595}$		$\frac{559}{279,5}$	$\frac{519}{259,5}$

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			

4. Минобрнауки России

325. Техническое перевооружение государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский государственный институт электронной техники" (технический университет), г. Москва, для создания базового центра проектирования	$\frac{78}{54}$	$\frac{48}{24}$	$\frac{30}{30}$					2009 - 2010	515,1	создание базового центра системного проектирования площадью 515,1 кв. метра
326. Реконструкция и техническое перевооружение государственного образовательного учреждения высшего профессионального	$\frac{50}{25}$	$\frac{50}{25}$						2008	500	создание базового центра системного проектирования площадью 500 кв. метров

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
образования "Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики" (технический университет), г. Москва, для создания базового центра проектирования										
327. Техническое первооружение федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет",	<u>200</u> 100					<u>200</u> 100		2012	400	создание базового центра системного проектирования площадью 400 кв. метров

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год			
г. Томск, для создания базового центра проектирования										
328. Техническое перевооружение федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана" для создания центра базового проектиро- вания, Московская область, Дмитровский район, пос. Орево, площадка Дмитровского филиала	<u>186,8</u> 93						<u>186,8</u> 93	2013	669	создание базового центра системного проектирования площадью 669 кв. метров

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе						Сроки реали- зации (годы)	Площадь объекта (кв. метров)	Ожидаемые результаты
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
Всего по Минобрнауки России	<u>514,8</u> 272	<u>50</u> 25	<u>48</u> 24	<u>30</u> 30		<u>200</u> 100	<u>186,8</u> 93			
5. ФСТЭК России										
329. Техническое переворужение федерального государственного унитарного предприятия "Производственное объединение "Октябрь", г. Каменск- Уральский Свердловской области	<u>836</u> 418*				<u>66,76</u> 33,38	<u>133,24</u> 66,62	<u>320</u> 160	<u>188</u> 94	<u>128</u> 64	создание новых производственных мощностей по выпуску оптоволоконных соединителей изделий микро- ** механики
Всего по ФСТЭК России	<u>836</u> 418				<u>66,76</u> 33,38	<u>133,24</u> 66,62	<u>320</u> 160	<u>188</u> 94	<u>128</u> 64	
Всего по разделу II	<u>78382,06</u> 40891,295	<u>1868,71</u> 1392,7	<u>1879,48</u> 1530,71	<u>2223,3</u> 1763	<u>6066,76</u> 3033,38	<u>20311,76</u> 10155,88	<u>17539,24</u> 8769,22	<u>14146,685</u> 7103,148	<u>14349,655</u> 7143,257	

* Размеры финансирования будут уточнены после утверждения в установленном порядке проектно-сметной документации.

** Конкретный состав оборудования и работ будет определен на этапе технико-экономического обоснования.

*** Мощность объекта может быть уточнена на стадии разработки проекта.

**** Объемы скорректированы и полностью возвращены в бюджет.

- Примечания: 1. Срок получения предусмотренных настоящим приложением результатов работ соответствует году окончания их финансирования.
2. В числителе указывается общая стоимость работ, в знаменателе - размер финансирования за счет средств федерального бюджета.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к федеральной целевой программе
"Развитие электронной компонентной базы
и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 19 августа 2014 г. № 829)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

объемов финансирования за счет средств федерального бюджета по государственным заказчикам федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Всего по Программе	102752,5207	5372,7	5772,01	5400	12963,38	25180	18400	15140,5487	14523,882
из них:									
Минпромторг России	89545,079	4757,7	5157,21	4952,62	11940	21953,26	15376,5	12909,332	12498,457
Роскосмос	5894,5	290	320	168	430	1776	1393	764	753,5
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"	5726,3667	240	246,5	179,38	400	1124,12	1235	1228,8167	1072,55
Минобрнауки России	1168,575	85	48,3	100	160	260	235,5	144,4	135,375

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
ФСТЭК России	418	-	-	-	33,38	66,62	160	94	64
Капитальные вложения - всего	40891,295	1392,7	1530,71	1763	3033,38	10155,88	8769,22	7103,148	7143,257
из них:									
Минпромторг России	36140,295	1267,7	1412,71	1695	2870	9233,26	7351,22	6049,648	6260,757
Роскосмос	1838	60	60	18	80	486	595	279,5	259,5
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"	2223	40	34	20	50	270	570	680	559
Минобрнауки России	272	25	24	30	-	100	93	-	-
ФСТЭК России	418	-	-	-	33,38	66,62	160	94	64
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - всего	61861,2257	3980	4241,3	3637	9930	15024,12	9630,78	8037,4007	7380,625
из них:									
Минпромторг России	53404,784	3490	3744,5	3257,62	9070	12720	8025,28	6859,684	6237,7
Роскосмос	4056,5	230	260	150	350	1290	798	484,5	494
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"	3503,3667	200	212,5	159,38	350	854,12	665	548,8167	513,55
Минобрнауки России	896,575	60	24,3	70	160	160	142,5	144,4	135,375

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к федеральной целевой программе
"Развитие электронной компонентной базы
и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 19 августа 2014 г. № 829)

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

**федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники"
на 2008 - 2015 годы за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников**

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Всего по Программе	172103,3593	7903,837	8478,112	8267,417	20961,76	42829,41	31985,41	26216,8344	25460,5789
в том числе:									
федеральный бюджет	102752,5207	5372,7	5772,01	5400	12963,38	25180	18400	15140,5487	14523,882
внебюджетные средства	69350,8386	2531,137	2706,102	2867,417	7998,38	17649,41	13585,41	11076,2857	10936,6969
Капитальные вложения - всего	78385,59	1868,71	1879,48	2223,3	6066,76	20311,76	17539,24	14146,685	14349,655
в том числе:									
федеральный бюджет	40891,295	1392,7	1530,71	1763	3033,38	10155,88	8769,22	7103,148	7143,257

	2008 - 2015 годы - всего	В том числе							
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
внебюджетные средства	37494,295	476,01	348,77	460,3	3033,38	10155,88	8770,02	7043,537	7206,398
Научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы - всего	93717,7693	6035,127	6598,632	6044,117	14895	22517,65	14446,17	12070,1494	11110,9239
в том числе:									
федеральный бюджет	61861,2257	3980	4241,3	3637	9930	15024,12	9630,78	8037,4007	7380,625
внебюджетные средства	31856,5436	2055,127	2357,332	2407,117	4965	7493,53	4815,39	4032,7487	3730,2989"

6. В приложении № 5 к указанной Программе:

а) в абзаце пятнадцатом цифры "175600,705" заменить цифрами "172099,8293", цифры "104656,296" заменить цифрами "102752,5207", цифры "70944,409" заменить цифрами "69347,3086", цифры "66746,5" заменить цифрами "68686,2", цифры "125754,3" заменить цифрами "126802,6";

б) в абзаце восемнадцатом цифры "1,57" заменить цифрами "1,6";

в) таблицы 1 - 3 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ,

**принятые для расчета коммерческой и бюджетной эффективности реализации федеральной целевой программы
"Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы**

(в ценах соответствующих лет, млн. рублей)

Показатели	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	За расчетный период
Условно-переменная часть текущих издержек производства (себестоимости) (процентов)	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	-
Годовой объем реализуемой продукции отрасли (объем продаж)	58000	70000	90000	110000	170000	210000	240000	270000	340000	420000	-
Инвестиции из всех источников финансирования - всего по Программе	7903,837	8478,112	8267,417	20961,76	42829,41	31985,41	26216,8344	25460,5789	-	-	172103,3593

в том числе:

Показатели	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	За расчетный период
средства федерального бюджета на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, капитальные вложения и прочие нужды	5372,7	5772,01	5400	12963,38	25180	18400	15140,5487	14523,882	-	-	102752,5207
из них капитальные вложения	1392,7	1530,71	1763	3033,38	10155,88	8769,22	7103,148	7143,257	-	-	40891,295
внебюджетные средства на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и капитальные вложения (собственные, заемные и др.)	2531,137	2706,102	2867,417	7998,38	17649,41	13585,41	11076,2857	10936,6969	-	-	69350,8386
налогооблагаемая база налога на имущество (среднегодовая стоимость основных промышленно-производственных фондов отрасли по остаточной стоимости)	33000	34500	36000	38000	41000	46000	54000	60000	61000	62000	-
Рентабельность реализованной продукции (процентов)	10	10	12	14	16	18	20	20	20	20	-
Амортизационные отчисления (процентов себестоимости)	3,5	3,8	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	-
Материалы (процентов себестоимости)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-

Показатели	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	За расчетный период
Фонд оплаты труда (процентов себестоимости)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-
Налог на имущество организаций (процентов)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-
Налог на прибыль организаций (процентов)	24	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-
Налог на доходы физических лиц (процентов)	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	-
Страховые взносы (процентов)	26	26	26	34	30	30	30	30	30	30	-
Налог на добавленную стоимость (процентов)	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	-
Норма дисконта (средняя за расчетный период) (процентов)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1

**Расчет коммерческой и бюджетной эффективности реализации федеральной целевой программы
"Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы**

(в ценах соответствующих лет, млн. рублей)

Наименование показателей	Расчетный период										За расчетный период	
	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		
	номер шага (m)											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Операционная и инвестиционная деятельность (коммерческая эффективность)												
Годовой объем реализованной продукции отрасли без налога на добавленную стоимость	58000	70000	90000	110000	170000	210000	240000	270000	340000	420000	-	
Себестоимость годового объема реализованной продукции отрасли	52727	63636	80357	96491	146552	177966	200000	225000	283333	350000	-	
Прибыль от реализации продукции	5273	6364	9643	13509	23448	32034	40000	45000	56667	70000	-	
Налогооблагаемая база налога на имущество (среднегодовая стоимость основных промышленно- производственных фондов отрасли по остаточной стоимости)	33000	34500	36000	38000	41000	46000	54000	60000	61000	62000	-	

Наименование показателей	Расчетный период										3а расчетный период	
	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		
	номер шага (m)											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Налог на имущество организаций	660	690	720	760	820	920	1080	1200	1220	1240	-	
Налогооблагаемая прибыль	4587,3	5727,3	8967,9	12833,3	22744,8	31072,9	38800	43650	54966,7	67900	-	
Налог на прибыль организаций	1100,9	1145,5	1793,6	2566,7	4549	6214,6	7760	8730	10993,3	13580	-	
Чистая прибыль	3486,3	4581,8	7174,3	10266,7	18195,9	24858,3	31040	34920	43973,3	54320	-	
Амортизационные отчисления в структуре себестоимости	1845,5	2418,2	3214,3	4342,1	7327,6	9788,1	12000	14625	19833,3	26250	-	
Материальные затраты в структуре себестоимости	26363,6	31818,2	40178,6	48245,6	73275,9	88983,1	100000	112500	141666,7	175000	-	
Фонд оплаты труда в структуре себестоимости	13181,8	15909,1	20089,3	24122,8	36637,9	44491,5	50000	56250	70833,3	87500	-	
Налог на добавленную стоимость	4745,5	5727,3	7232,1	8684,2	13189,7	16016,9	18000	20250	25500	31500	-	
Налог на доходы физических лиц	1713,6	2068,2	2611,6	3136	4762,9	5783,9	6500	7312,5	9208,3	11375	-	
Страховые взносы	3427,3	4136,4	5223,2	8201,8	10991,4	13347,5	15000	16875	21250,3	26250	-	

Наименование показателей	Расчетный период											За расчетный период
	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		
	номер шага (m)											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды (приток в бюджет)	10546,4	12621,8	15787	20781,9	29764	36068,3	40580	45637,5	57178,3	70365	339330,2	
Сальдо от операционной деятельности. Чистый доход организаций (чистая прибыль и амортизационные отчисления)	5331,8	7000	10388,6	14608,8	25523,4	34646,4	43040	49545	63806,7	80570	-	
Коэффициент дисконтирования (норма дисконта E=0,1)	1	0,909	0,826	0,751	0,683	0,621	0,564	0,513	0,467	0,424	-	
Сальдо от операционной деятельности с учетом дисконтирования. Чистый доход организаций с учетом дисконтирования	5331,8	6363,6	8585,6	10975,8	17432,9	21512,7	24295	25424,4	29766,3	34169,5	183857,6	
Величина инвестиций из всех источников финансирования (оттоки)	7903,837	8478,112	8267,417	20961,76	42829,41	31985,41	26216,8344	25460,5789	-	-	172103,3593	
Сальдо суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности без дисконтирования	-2572,1	-1478,1	2121,2	-6353	-17306	2661	16763,6	24147,6	63806,7	80570	-	

Наименование показателей	Расчетный период											За расчетный период
	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		
	номер шага (m)											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Величина инвестиций из всех источников финансирования (оттоки) с учетом дисконтирования	7903,8	7707,4	6832,6	15748,9	29253,1	19860,4	14832,4	13032,9	-	-	115171,4	
Сальдо суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования	-2572,1	-1343,7	1753	-4773,1	-11820,2	1652,3	9462,6	12391,5	29766,3	34169,5	68686,2	
Сальдо накопленного суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования (нарастающим итогом)	-2572,1	-3915,8	-2162,8	-6935,9	-18756,1	-17103,8	-7641,2	4750,3	34516,6	68686,2	-	
Срок окупаемости инвестиций (период возврата) (лет)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 лет	
Индекс доходности (рентабельность инвестиций)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	

Наименование показателей	Расчетный период										За расчетный период
	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Финансовая и операционная деятельность (бюджетная эффективность)

Средства федерального бюджета на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, капитальные вложения и прочие нужды (отток из бюджета)	5372,7	5772,01	5400	12963,38	25180	18400	15140,5487	14523,882	-	-	102752,5207
Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды	10546,4	12621,8	15787	20781,9	29764	36068,3	40580	45637,5	57178,3	70365	339330,2
Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды с учетом дисконтирования	10546,4	11474,4	13047,1	15613,8	20329,2	22395,6	22906,4	23419,3	26674,1	29841,6	196247,7
Отток бюджетных средств	5372,7	5772,01	5400	12963,38	25180	18400	15140,5487	14523,882	-	-	102752,5207
Отток бюджетных средств с учетом дисконтирования	5372,7	5247,3	4462,8	9739,6	17198,3	11425	8546,4	7453	-	-	69445,1
Сальдо суммарного потока от финансирования и операционной деятельности с учетом дисконтирования	5173,7	6227,1	8584,3	5874,2	3130,9	10970,6	14359,9	15966,2	26674,1	29841,6	126802,6

Наименование показателей	Расчетный период										За расчетный период
	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	
	номер шага (m)										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Чистый дисконтированный доход государства или бюджетный эффект	5173,7	11400,8	19985	25859,2	28990,1	39960,8	54320,7	70286,9	96961	126802,6	-
Индекс доходности бюджетных средств	2	2,2	2,9	1,6	1,2	2	2,7	3,1	-	-	2,8
Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды с учетом дисконтирования	10546,4	11474,4	13047,1	15613,8	20329,2	22395,6	22906,4	23419,3	26674,1	29841,6	196247,7
Удельный вес средств федерального бюджета в общем объеме финансирования (степень участия государства)	0,68	0,68	0,65	0,62	0,59	0,58	0,58	0,57	-	-	0,6
Период возврата бюджетных средств (лет)											1 год
Уровень безубыточности	0,79	0,79	0,76	0,73	0,7	0,68	0,66	0,66	0,66	0,66	0,68

ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности реализации федеральной целевой программы
"Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники"
на 2008 - 2015 годы

(млн. рублей)

Наименование показателей	2008 - 2017 годы
Всего инвестиций (в ценах соответствующих лет)	172103,3593
в том числе:	
средства федерального бюджета	102752,5207
внебюджетные средства	69350,8386
Показатели коммерческой эффективности	
Чистый дисконтированный доход в 2017 году	68686,2
Срок окупаемости инвестиций по чистой прибыли организации (лет)	7 лет
Индекс доходности (рентабельность) инвестиций по чистой прибыли	1,6
Уровень безубыточности	0,68
Показатели бюджетной эффективности	
Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды с учетом дисконтирования	196247,7
Бюджетный эффект	126802,6
Индекс доходности (рентабельность) бюджетных ассигнований по налоговым поступлениям	2,8

Наименование показателей	2008 - 2017 годы
Удельный вес средств федерального бюджета в общем объеме финансирования (степень участия государства)	0,6
Срок окупаемости бюджетных ассигнований по налоговым поступлениям (лет)	1 год".